

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報(B2)

(11) 特許番号

特許第6142151号
(P6142151)

(45) 発行日 平成29年6月7日(2017.6.7)

(24) 登録日 平成29年5月19日(2017.5.19)

(51) Int. Cl.	F I		
H05B 33/04 (2006.01)	H05B 33/04		
H01L 51/50 (2006.01)	H05B 33/14	A	
H05B 33/12 (2006.01)	H05B 33/12	B	
H05B 33/22 (2006.01)	H05B 33/22	Z	
G09F 9/30 (2006.01)	G09F 9/30	365	

請求項の数 9 (全 30 頁)

(21) 出願番号	特願2012-176507 (P2012-176507)	(73) 特許権者	514188173 株式会社 J O L E D 東京都千代田区神田錦町三丁目2 3 番地
(22) 出願日	平成24年8月8日(2012.8.8)	(74) 代理人	110001357 特許業務法人つばさ国際特許事務所
(65) 公開番号	特開2014-44793 (P2014-44793A)	(72) 発明者	齊藤 高寿 東京都港区港南1丁目7番1号 ソニー株式会社内
(43) 公開日	平成26年3月13日(2014.3.13)	(72) 発明者	和泉 健一 東京都港区港南1丁目7番1号 ソニー株式会社内
審査請求日	平成27年5月18日(2015.5.18)	(72) 発明者	寺口 晋一 東京都港区港南1丁目7番1号 ソニー株式会社内
(31) 優先権主張番号	特願2012-170618 (P2012-170618)		
(32) 優先日	平成24年7月31日(2012.7.31)		
(33) 優先権主張国	日本国(JP)		

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 表示装置および電子機器

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】

基板と、

前記基板上における表示領域に配列され、発光層を各々含む複数の発光素子と、
前記基板と前記発光層との間の階層に位置する第1の無機層と、
前記複数の発光素子を覆う第2の無機層と、
前記第1の無機層と前記第2の無機層との間の階層に位置する第3の無機層と、
前記基板上における前記表示領域を取り囲む周辺領域において、前記第2の無機層と前記第3の無機層との間の階層に位置する第1の有機層と、
前記周辺領域において、前記第1の無機層と前記第3の無機層との間の階層に位置する第2の有機層と

を有し、

前記周辺領域において、前記第1の有機層の外縁を覆うように、前記第2の無機層と前記第3の無機層とが接し、前記第2の有機層の外縁を覆うように、前記第1の無機層と前記第2の無機層とが接している

表示装置。

【請求項2】

前記第1の有機層の外縁から前記表示領域の外縁までの第1の距離と、前記第2の有機層の外縁から前記表示領域の外縁までの第2の距離とは異なる

請求項1に記載の表示装置。

【請求項 3】

前記第 1 の無機層は絶縁膜である
請求項 1 または請求項 2 に記載の表示装置。

【請求項 4】

前記第 1 の無機層は金属膜である
請求項 1 または請求項 2 に記載の表示装置。

【請求項 5】

前記第 2 の無機層は絶縁膜または金属膜である
請求項 1 から請求項 3 のいずれか 1 項に記載の表示装置。

【請求項 6】

前記第 3 の無機層は絶縁膜である
請求項 1 から請求項 5 のいずれか 1 項に記載の表示装置。

【請求項 7】

前記基板上に、前記第 1 の無機層とゲート絶縁膜とを有する
請求項 1 から請求項 6 のいずれか 1 項に記載の表示装置。

【請求項 8】

前記第 1 の無機層は防湿膜である
請求項 1 から請求項 7 のいずれか 1 項に記載の表示装置。

【請求項 9】

表示装置を備えた電子機器であって、
前記表示装置は、

基板と、

前記基板上における表示領域に配列され、発光層を各々含む複数の発光素子と、
前記基板と前記発光層との間の階層に位置する第 1 の無機層と、
前記複数の発光素子を覆う第 2 の無機層と、
前記第 1 の無機層と前記第 2 の無機層との間の階層に位置する第 3 の無機層と、
前記基板上における前記表示領域を取り囲む周辺領域において、前記第 2 の無機層と前記第 3 の無機層との間の階層に位置する第 1 の有機層と、

前記周辺領域において、前記第 1 の無機層と前記第 3 の無機層との間の階層に位置する第 2 の有機層と

を有し、

前記周辺領域において、前記第 1 の有機層の外縁を覆うように、前記第 2 の無機層と前記第 3 の無機層とが接し、前記第 2 の有機層の外縁を覆うように、前記第 1 の無機層と前記第 2 の無機層とが接している

電子機器。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本開示は、有機層を含む自発光型の発光素子を有する表示装置、およびそのような表示装置を備えた電子機器に関する。

【背景技術】

【0002】

有機材料の有機エレクトロルミネセンス (EL; Electro Luminescence) 現象を利用して発光する有機 EL 素子は、陽極と陰極との間に有機正孔輸送層や有機発光層を積層させた有機層を設けて構成されており、低電圧直流駆動による高輝度発光が可能な発光素子として注目されている。ところが、この有機 EL 素子を用いた表示装置 (有機 EL 表示装置) では、吸湿によって有機 EL 素子における有機層の劣化が生じ、有機 EL 素子における発光輝度が低下したり発光が不安定になったりするなど、経時的な安定性が低くかつ寿命が短いといった問題があった。

【0003】

10

20

30

40

50

そこで、例えば特許文献1には、基板における有機EL素子やその他の回路が形成された素子形成面側に、封止のためのカバー材を配置し、基板とカバー材との周縁部をシール材で封止するようにした有機EL表示装置が提案されている。また、この特許文献1には、水蒸気などの浸入を防ぐ保護膜として、シール材の外側を硬質な炭素膜で覆う構成も提案されている。このような構成により、基板上に形成された有機EL素子が外部から完全に遮断され、有機EL素子の酸化による劣化を促す水分や酸素等の物質が外部から浸入することを防ぐことが可能となっている。

【0004】

また、この他にも、基板における有機EL素子やその他の回路が形成された素子形成面側に、接着剤を介して封止のためのカバー材を貼り合わせるようにした、完全固体型の有機EL表示装置も提案されている。

10

【0005】

さらに、表示領域を囲む位置（表示領域の外縁側）に、上記した有機絶縁膜をその内部領域側と外部領域側に分離する分離溝を形成するようにした有機EL表示装置も提案されている（例えば、特許文献2, 3参照）。このような分離溝を設けることにより、有機絶縁膜における上記外部領域側に存在する水分が、この有機絶縁膜内を通過して内部領域側（表示領域側）に浸入することが回避される。したがって、表示装置内に取り残された水分が有機絶縁膜を通過することに起因した有機層（有機EL素子）の劣化を抑えることが可能となっている。

【先行技術文献】

20

【特許文献】

【0006】

【特許文献1】特開2002-93576号公報

【特許文献2】特開2006-54111号公報

【特許文献3】特開2008-283222号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0007】

ところで最近では、いわゆるタブレット型パーソナルコンピュータ（PC）やスマートフォン（多機能型携帯電話）などの携帯型情報端末機器にも有機EL表示装置が搭載されるようになってきている。こうした携帯型情報端末は、携帯性確保のため、本体の寸法をあまり大きくすることができない。その一方、使用者における視認性および操作性確保の観点から、できるだけ有効画面領域を大きく確保する必要がある。したがって、携帯型情報端末の本体における、有効画面領域以外の周辺領域の占有面積をできるだけ縮小する、いわゆる狭額縁化が望まれる。

30

【0008】

しかしながら、特許文献2, 3に提案されている構造では、例えば白色有機EL素子等の場合のように、有機層等を成膜する際にエリアマスクを使用する場合、狭額縁化が困難であった。すなわち、エリアマスクのアライメントずれ（マスクずれ領域）と膜の回り込み（テーパー領域）とを考慮すると、実際には、上記した分離溝を、表示領域から十分に離れた位置に形成する必要がある。このため、額縁を広く取る必要が生じ（表示領域と周辺領域との間の距離を広くする必要が生じ）、狭額縁化が困難となってしまう。加えて、表示領域と周辺領域との間の距離を広くする必要が生じることから、この領域（分離溝の内部領域）における有機絶縁層内に含まれる水分が有機層へ侵入することに起因して、有機層が劣化してしまうことになる。

40

【0009】

本開示はかかる問題点に鑑みてなされたもので、その目的は、水分による発光素子の劣化を抑え、高い信頼性を有すると共により大きな有効画面領域を有する表示装置、およびそのような表示装置を備えた電子機器を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

50

【0010】

本開示の表示装置は、以下の各構成要素を有するものである。

(1) 基板。

(2) 基板上における表示領域に配列され、発光層を各々含む複数の発光素子。

(3) 基板と発光層との間の階層に位置する第1の無機層。

(4) 複数の発光素子を覆う第2の無機層。

(5) 第1の無機層と第2の無機層との間の階層に位置する第3の無機層。

(6) 基板上における表示領域を取り囲む周辺領域において、第2の無機層と第3の無機層との間の階層に位置する第1の有機層。

(7) 周辺領域において、第1の無機層と第3の無機層との間の階層に位置する第2の有機層。

10

ここで、周辺領域において、第1の有機層の外縁を覆うように、第2の無機層と第3の無機層とが接し、第2の有機層の外縁を覆うように、第1の無機層と第2の無機層とが接している。

【0011】

本開示の電子機器は、上記本開示の表示装置を備えたものである。

【0012】

本開示の表示装置および電子機器では、周辺領域において、第1の有機層の外縁を覆うように第2の無機層と第3の無機層とが接し、第2の有機層の外縁を覆うように第1の無機層と第2の無機層とが接している。このため、第1の有機層および第2の有機層が、水分を含む外気から十分に遮蔽される。

20

【発明の効果】

【0013】

本開示の表示装置および電子機器によれば、周辺領域において、第1の有機層の外縁を覆うように第2の無機層と第3の無機層とが接し、第2の有機層の外縁を覆うように第1の無機層と第2の無機層とが接するようにしたので、簡素な構造でありながら周辺領域から表示領域への水分浸入を効果的に防止することができる。よって、水分による発光素子の劣化を抑え、高い信頼性を実現すると共に狭額縁化をも図ることができる。

【図面の簡単な説明】

30

【0014】

【図1】本開示の一実施の形態に係る表示装置の構成を表す図である。

【図2】図1に示した画素駆動回路の一例を表す図である。

【図3】図1に示した表示領域の構成を表す平面図である。

【図4】図1に示した表示領域の構成を表す断面図である。

【図5】図1に示した表示領域の構成を表す他の断面図である。

【図6】図4および図5に示した有機層を拡大して表す断面図である。

【図7】第1の変形例としての表示装置の要部構成を表す断面図である。

【図8】第2の変形例としての表示装置の要部構成を表す断面図である。

【図9A】第3の変形例としての表示装置の要部構成を表す断面図である。

40

【図9B】第4の変形例としての表示装置の要部構成を表す断面図である。

【図9C】第5の変形例としての表示装置の要部構成を表す拡大断面図である。

【図10】第6の変形例としての表示装置の要部構成を表す断面図である。

【図11】上記実施の形態等の表示装置を含むモジュールの概略構成を表す平面図である。

【図12】表示装置の第1の適用例としてのテレビジョン装置の外観を表す斜視図である。

【図13A】表示装置の第2の適用例としてのデジタルカメラにおける外観を表す第1の斜視図である。

【図13B】表示装置の第2の適用例としてのデジタルカメラにおける外観を表す第2の

50

斜視図である。

【図 1 4】表示装置の第 3 の適用例としてのノート型パーソナルコンピュータの外観を表す斜視図である。

【図 1 5】表示装置の第 4 の適用例としてのビデオカメラの外観を表す斜視図である。

【図 1 6 A】表示装置の第 5 の適用例としての携帯電話機における、閉じた状態の外観を表す正面図、左側面図、右側面図、上面図、下面図である。

【図 1 6 B】表示装置の第 5 の適用例としての携帯電話機における、開いた状態の正面図および側面図である。

【図 1 7 A】表示装置を用いた第 6 の適用例としてのタブレット型 P C における外観を表す第 1 の斜視図である。

10

【図 1 7 B】表示装置を用いた第 6 の適用例としてのタブレット型 P C における外観を表す第 2 の斜視図である。

【図 1 8】第 7 の変形例としての表示装置の要部構成を表す断面図である。

【図 1 9 A】第 8 の変形例としての表示装置の要部構成を表す断面図である。

【図 1 9 B】第 9 の変形例としての表示装置の要部構成を表す拡大断面図である。

【図 2 0】第 1 0 の変形例としての表示装置の要部構成を表す断面図である。

【図 2 1 A】第 1 1 の変形例としての表示装置の要部構成を表す断面図である。

【図 2 1 B】第 1 2 の変形例としての表示装置の要部構成を表す断面図である。

【図 2 2 A】第 1 3 の変形例としての表示装置の要部構成を表す断面図である。

20

【図 2 2 B】第 1 3 の変形例としての表示装置の要部構成を表す他の断面図である。

【図 2 3】図 2 2 A , 2 2 B に示した表示装置の製造方法を説明するための斜視図である。

【図 2 4 A】第 1 4 の変形例としての表示装置の要部構成を表す断面図である。

【図 2 4 B】第 1 4 の変形例としての表示装置の要部構成を表す他の断面図である。

【図 2 5】第 1 5 の変形例としての表示装置の要部構成を表す断面図である。

【図 2 6】図 2 5 に示した表示装置の製造方法を説明するための斜視図である。

【図 2 7】第 1 6 の変形例としての表示装置の要部構成を表す断面図である。

【発明を実施するための形態】

【0015】

30

以下、本開示の実施の形態および適用例について、図面を参照して詳細に説明する。なお、説明は以下の順序で行う。

1 . 実施の形態 (図 1 ~ 図 1 0) : 表示装置

2 . 表示装置の適用例 (図 1 1 ~ 1 7) : 電子機器

【0016】

< 実施の形態 >

[有機 E L 表示装置の全体構成例]

図 1 は、本開示の一実施の形態に係る有機 E L 表示装置 1 (以下、単に表示装置 1 という。) の全体構成例を表すものである。表示装置 1 は、有機 E L テレビジョン装置などとして用いられるものであり、基板 1 1 1 の上に表示領域 1 1 0 A が設けられている。この表示領域 1 1 0 A 内には、複数のサブ画素 1 0 R , 1 0 G , 1 0 B がマトリクス状に配置されている。サブ画素 1 0 R は赤色を表示し、サブ画素 1 0 G は緑色を表示し、サブ画素 1 0 B は青色を表示する。ここでは、同色を表示するサブ画素を Y 方向に一列に並べ、それを X 方向に順に繰り返して配置するようにしている。したがって、X 方向に並ぶ 3 つのサブ画素の組み合わせが一つの画素 (ピクセル) を構成している。また、表示領域 1 1 0 A の周辺 (外縁側 , 外周側) に位置する周辺領域 1 1 0 B には、映像表示用のドライバ (後述する周辺回路 1 2 B) である信号線駆動回路 1 2 0 および走査線駆動回路 1 3 0 が設けられている。

40

【0017】

信号線駆動回路 1 2 0 は、信号供給源 (図示せず) から供給される輝度情報に応じた映

50

像信号の信号電圧を、信号線 120A を介して選択された画素に供給するものである。

【0018】

走査線駆動回路 130 は、入力されるクロックパルスに同期してスタートパルスを順にシフト（転送）するシフトレジスタなどによって構成されている。走査線駆動回路 130 は、各画素への映像信号の書き込みに際し行単位でそれらを走査し、各走査線 130A に走査信号を順次供給するものである。

【0019】

表示領域 110A 内には、画素駆動回路 140 が設けられている。図 2 は、この画素駆動回路 140 の一例（サブ画素 10R, 10G, 10B の画素回路の一例）を表したものである。画素駆動回路 140 は、後述する第 1 電極層 13 の下層（後述の画素駆動回路形成層 112）に形成されたアクティブ型の駆動回路である。この画素駆動回路 140 は、駆動トランジスタ Tr1 および書込トランジスタ Tr2 と、それらの間のキャパシタ（保持容量）Cs とを有している。画素駆動回路 140 はまた、第 1 の電源ライン（Vcc）および第 2 の電源ライン（GND）の間において、駆動トランジスタ Tr1 に直列に接続された白色有機 EL 素子 10W（以下、単に EL 素子 10W という。）を有している。すなわち、サブ画素 10R, 10G, 10B にはそれぞれ、この EL 素子 10W が設けられている。駆動トランジスタ Tr1 および書込トランジスタ Tr2 は、一般的な薄膜トランジスタ（TFT; Thin Film Transistor）により構成され、その構成は例えば逆スタガ構造（いわゆるボトムゲート型）でもよいしスタガ構造（トップゲート型）でもよく、特に限定されない。

【0020】

画素駆動回路 140 において、列方向には信号線 120A が複数配置され、行方向には走査線 130A が複数配置されている。各信号線 120A と各走査線 130A との交差点が、サブ画素 10R, 10G, 10B のいずれか 1 つに対応している。各信号線 120A は、信号線駆動回路 120 と接続され、この信号線駆動回路 120 から信号線 120A を介して書き込みトランジスタ Tr2 のソース電極に画像信号が供給されるようになっている。各走査線 130A は走査線駆動回路 130 と接続され、この走査線駆動回路 130 から走査線 130A を介して書込トランジスタ Tr2 のゲート電極に走査信号が順次供給されるようになっている。

【0021】

[表示装置の平面構成例]

図 3 に、XY 平面に広がる表示領域 110A の一構成例を表す。ここでは、第 2 電極層 16、充填層 18 および封止基板 19（いずれも後出）を取り去った状態の表示領域 110A と、それを取り囲む周辺領域 110B とを、上方から眺めた平面構成を模式的に表す。図 3 に示したように、表示領域 110A には、複数の EL 素子 10W が X 方向および Y 方向に並び、全体としてマトリックス状に配列されている。より詳細には、開口規定絶縁膜 24 によって相互に分離され、輪郭が規定された発光部 20 を各々含む EL 素子 10W が、サブ画素 10R, 10G, 10B に対応して 1 つずつ配置されている。

【0022】

図 3 において、発光部 20 を取り囲む破線で示した矩形は有機層 14 が形成された領域を表す。さらに、有機層 14 が形成された領域を取り囲む破線で示した矩形は、第 1 電極層 13 が形成された領域を表す。第 1 電極層 13 の一部には、例えば駆動トランジスタ Tr1 のソース電極との導通を図るコンタクト部 124 が設けられている。なお、X 方向および Y 方向に並ぶサブ画素の数は任意に設定されるものであり、図 3 に示した数に限定されるものではない。また、例えば黄色および白色を表示するサブ画素をさらに設け、1 つの画素が 4 以上の EL 素子 10W を含むようにしてもよい。

【0023】

[表示装置 1 の断面構成]

図 4 は、表示領域 110A と周辺領域 110B との境界近傍における、図 3 に示した I-V-I 線に沿った XZ 断面の概略構成を示すものである。また図 5 は、図 3 に示した表

10

20

30

40

50

示領域 110 の、V-V 線に沿った断面図である。さらに図 6 は、図 4 および図 5 に示した有機層 14 の断面の一部を拡大して表したものである。

【0024】

本実施の形態の表示装置 1 は、前述した EL 素子 10W と後述するカラーフィルタとを用いることによって R (赤), G (緑), B (青) のいずれかの色光が上面 (基板 111 と対向する封止基板 19) から出射される、上面発光型 (いわゆるトップエミッション型) の表示装置である。図 4 に示したように、表示領域 110A では、基板 111 に画素駆動回路形成層 112 が設けられてなる基体 11 の上に、EL 素子 10W を含む発光素子形成層 12 が形成されている。EL 素子 10W の上には、防湿膜 17、充填層 18 および封止基板 19 がこの順に設けられている。表示領域 110A と周辺領域 110B とは、封止基板 19 の、基板 111 と対向する対向面 19S における周縁部に沿って設けられたシール部 23 によって仕切られている。EL 素子 10W は、画素駆動回路形成層 112 の最上層である平坦化膜 218 の上に、アノード電極としての第 1 電極層 13、発光層 14C (後出) を含む有機層 14、およびカソード電極としての第 2 電極層 16 が各々順に積層されたものである。有機層 14 および第 1 電極層 13 は、開口規定絶縁膜 24 によって EL 素子 10W ごとに分離されている。なお、平坦化膜 218 および開口規定絶縁膜 24 は、いずれも、例えばポリイミド、アクリルまたはシロキサン等のパターン精度が良い有機材料により構成されている。一方、第 2 電極層 16 は、全ての EL 素子 10W に共通して設けられている。なお、図 4 では、画素駆動回路形成層 112 における駆動トランジスタ Tr1 および書込トランジスタ Tr2 などの詳細な構成については図示を省略した。

【0025】

基体 11 は、基板 111 に、画素駆動回路 140 を含む画素駆動回路形成層 112 が設けられたものである。基板 111 は EL 素子 10W が配列形成される支持体であって、例えば、石英、ガラス、金属箔、もしくは樹脂製のフィルムやシートなどが用いられる。この中でも石英やガラスが好ましく、樹脂製の場合には、その材質としてポリメチルメタクリレート (PMMA) に代表されるメタクリル樹脂類、ポリエチレンテレフタレート (PET)、ポリエチレンナフタレート (PEN)、ポリブチレンナフタレート (PBN) などのポリエステル類、もしくはポリカーボネート樹脂などが挙げられるが、透水性や透ガス性を抑える積層構造、表面処理を行うことが必要である。基板 111 の表面には、第 1 階層の金属層として、駆動トランジスタ Tr1 のゲート電極である金属層 211G と、書込トランジスタ Tr2 のゲート電極である金属層 221G (図 5) と、信号線 120A (図 5) とがそれぞれ設けられている。これら金属層 211G, 221G および信号線 120A は、窒化ケイ素や酸化ケイ素などからなるゲート絶縁膜 212 によって覆われている。

【0026】

ゲート絶縁膜 212 上の、金属層 211G, 221G に対応する領域には、アモルファスシリコンなどの半導体薄膜からなるチャネル層 213, 223 が設けられている。チャネル層 213, 223 上には、その中心領域であるチャネル領域 213R, 223R を占めるように絶縁性のチャネル保護膜 214, 224 が設けられており、その両側の領域には、n 型アモルファスシリコンなどの n 型半導体薄膜からなるドレイン電極 215D, 225D およびソース電極 215S, 225S が設けられている。これらドレイン電極 215D, 225D およびソース電極 215S, 225S は、チャネル保護膜 214, 224 によって互いに分離されており、それらの端面がチャネル領域 213R, 223R を挟んで互いに離間している。さらに、ドレイン電極 215D, 225D およびソース電極 215S, 225S をそれぞれ覆うように、第 2 階層の金属層として、ドレイン配線としての金属層 216D, 226D およびソース配線としての金属層 216S, 226S が設けられている。金属層 216D, 226D および金属層 216S, 226S は、例えばチタン (Ti) 層、アルミニウム (Al) 層、およびチタン層を順に積層した構造を有するものである。第 2 階層の金属層としては、上記の金属層 216D, 226D および金属層 216S, 226S のほか、走査線 130A (図示せず) が設けられている。金属層 216S

は、周辺領域 110B において FPC などの外部との接続配線 31 と接続されている (図 4)。

【0027】

画素駆動回路 140 は、例えば酸化シリコン (SiO_x)、窒化シリコン (SiN_x)、酸化窒化シリコン (SiN_xO_y)、酸化チタン (TiO_x) または酸化アルミニウム (Al_xO_y) などの、水分透過性が低い無機材料からなる保護膜 (パッシベーション膜) 217 によって全体的に覆われており、その上には、絶縁性を有する平坦化膜 218 が設けられている。平坦化膜 218 は、その表面が極めて高い平坦性を有するものであることが望まれる。また、平坦化膜 218 および保護膜 217 の一部領域には、微細なコンタクト部 124 が設けられている (図 4)。コンタクト部 124 には第 1 電極層 13 が充填されており、駆動トランジスタ Tr1 のソース電極を構成する金属層 216S との導通がなされている。

10

【0028】

平坦化膜 218 の上に形成された下部電極である第 1 電極層 13 は反射層としての機能も兼ねており、できるだけ高い反射率を有する材料によって構成することが発光効率を高める上で望ましい。そのため、第 1 電極層 13 は、例えばアルミニウム (Al) やアルミニウムネオジウム合金 (AlNd) などの高反射率材料によって構成される。第 1 電極層 13 は、例えば、積層方向の厚み (以下、単に厚みと言う) が 10 nm 以上 1000 nm 以下のものである。第 1 電極層 13 の構成材料としては、上記材料に限られず、クロム (Cr)、金 (Au)、白金 (Pt)、ニッケル (Ni)、銅 (Cu)、タングステン (W) あるいは銀 (Ag) などの金属元素の単体または合金でもよい。また、これらの金属元素の単体または合金よりなる金属膜と、インジウムとスズの酸化物 (ITO)、InZnO (インジウム亜鉛オキシド)、酸化亜鉛 (ZnO) とアルミニウム (Al) との化合物などの透明導電膜との積層構造を有していてもよい。

20

【0029】

開口規定絶縁膜 24 は、隣り合う EL 素子 10W における第 1 電極層 13 および有機層 14 同士の隙間、すなわち、発光部 20 同士の隙間を埋めるように設けられている。また、開口規定絶縁膜 24 は隔壁とも呼ばれ、第 1 電極層 13 と、第 2 電極層 16 との絶縁性を確保すると共に、EL 素子 10W の発光部 20 の輪郭を正確に画定するものでもある。すなわち、開口規定絶縁膜 24 によって発光領域が規定される。開口規定絶縁膜 24 は、さらに、後述する製造工程においてインクジェットまたはノズルコート方式による塗布を行う際の隔壁としての機能も有している。なお、有機層 14 ないし第 2 電極層 16 は、開口だけでなく開口規定絶縁膜 24 の上にも設けられていてもよいが、発光が生じるのは開口規定絶縁膜 24 の開口に相当する発光部 20 のみである。

30

【0030】

有機層 14 は、開口規定絶縁膜 24 によって画定された発光部 20 に全面に亘って隙間無く形成されている。有機層 14 は、例えば図 6 に示したように、第 1 電極層 13 の側から正孔注入層 14A、正孔輸送層 14B、発光層 14C、電子輸送層 14D が順に積層された構成を有する。但し、発光層 14C 以外の層は、必要に応じて設ければよい。

【0031】

正孔注入層 14A は、発光層 14C への正孔注入効率を高めるためのものであると共に、リークを防止するためのパツファ層である。正孔注入層 14A の厚みは例えば 5 nm ~ 100 nm であることが好ましく、より好ましくは 8 nm ~ 50 nm である。正孔注入層 14A の構成材料は、電極や隣接する層の材料との関係で適宜選択すればよく、ポリアニリン、ポリチオフェン、ポリピロール、ポリフェニレンビニレン、ポリチエニレンビニレン、ポリキノリン、ポリキノキサリン およびそれらの誘導体、芳香族アミン構造を主鎖又は側鎖に含む重合体などの導電性高分子、金属フタロシアニン (銅フタロシアニン等)、カーボンなどが挙げられる。正孔注入層 14A に用いられる材料が高分子材料である場合には、その高分子材料の重量平均分子量 (Mw) は 1 万 ~ 30 万の範囲であればよく、特に 5000 ~ 20 万程度が好ましい。また、2000 ~ 1 万程度のオリゴマーを用いても

40

50

よいが、Mwが5000未満では正孔輸送層以後の層を形成する際に、正孔注入層が溶解してしまうおそれがある。また30万を超えると材料がゲル化し、成膜が困難になるおそれがある。正孔注入層14Aの構成材料として使用される典型的な導電性高分子としては、例えばポリアニリン、オリゴアニリンおよびポリ(3,4-エチレンジオキシチオフェン)(PEDOT)などのポリジオキシチオフェンが挙げられる。その他、エイチ・シー・スタルク製Nafion(商標)で市販されているポリマー、または商品名Liquion(商標)で溶解形態で市販されているポリマーや、日産化学製エルソース(商標)や、綜研化学製導電性ポリマーベラゾール(商標)などがある。

【0032】

正孔輸送層14Bは、発光層14Cへの正孔輸送効率を高めるためのものである。正孔輸送層14Bの厚みは、素子の全体構成にもよるが、例えば10nm~200nmであることが好ましく、さらに好ましくは15nm~150nmである。正孔輸送層14Bを構成する高分子材料としては、有機溶媒に可溶性発光材料、例えば、ポリビニルカルバゾール、ポリフルオレン、ポリアニリン、ポリシランまたはそれらの誘導体、側鎖または主鎖に芳香族アミンを有するポリシロキサン誘導体、ポリチオフェンおよびその誘導体、ポリピロールなどを用いることができる。正孔輸送層14Bに用いられる材料が高分子材料である場合には、その重量平均分子量(Mw)は5万~30万であることが好ましく、特に、10万~20万であることが好ましい。Mwが5万未満では、発光層14Cを形成するときに、高分子材料中の低分子成分が脱落し、正孔注入層14A、正孔輸送層14Bにドットが生じるため、有機EL素子の初期性能が低下したり、素子の劣化を引き起こしたりするおそれがある。一方、30万を超えると、材料がゲル化するため、成膜が困難になるおそれがある。なお、重量平均分子量(Mw)は、テトラヒドロフランを溶媒として、ゲル浸透クロマトグラフィー(GPC; Gel Permeation Chromatography)により、ポリスチレン換算の重量平均分子量を求めた値である。

【0033】

発光層14Cは、電界をかけることにより電子と正孔との再結合が起こり、光を発生するものである。発光層14Cの厚みは、素子の全体構成にもよるが、例えば10nm~200nmであることが好ましく、さらに好ましくは15nm~150nmである。発光層14Cは高分子(発光)材料に低分子材料が添加された混合材料により構成されている。ここで低分子材料とは、モノマーまたはこのモノマーを2~10個結合したオリゴマーとし、5万以下の重量平均分子量を有するものが好ましい。なお、重量平均分子量が上記範囲を超えた低分子材料を必ずしも除外するものではない。発光層14Cは、例えばインクジェット等の塗付法により形成してもよい。その際、高分子材料および低分子材料を例えばトルエン、キシレン、アニソール、シクロヘキサノン、メシチレン(1,3,5-トリメチルベンゼン)、プサイドクメン(1,2,4-トリメチルベンゼン)、ジハイドロベンゾフラン、1,2,3,4-テトラメチルベンゼン、テトラリン、シクロヘキシルベンゼン、1-メチルナフタレン、p-アニシルアルコール、ジメチルナフタレン、3-メチルピフェニル、4-メチルピフェニル、3-イソプロピルピフェニル、モノイソプロピルナフタレンなどの有機溶媒に少なくとも1種類以上使って溶解し、この混合溶液を用いて形成する。発光層14Cを構成する高分子材料としては、例えばポリフルオレン系高分子誘導体や、(ポリ)パラフェニレンビニレン誘導体、ポリフェニレン誘導体、ポリビニルカルバゾール誘導体、ポリチオフェン誘導体、ペリレン系色素、クマリン系色素、ローダミン系色素、あるいは上記高分子に有機EL材料をドーブしたものが挙げられる。ドーブ材料としては、例えばルブレン、ペリレン、9,10ジフェニルアントラセン、テトラフェニルプタジエン、ナイルレッド、クマリン6等を用いることができる。

【0034】

また、発光層14Cを構成する高分子材料に低分子材料を添加することが好ましい。発光層14Cに添加する低分子材料は、低分子化合物が同じ反応または類似の反応を連鎖的に繰り返すことにより生じた高分子量の重合体または縮合体の分子からなる化合物以外のものであって、分子量が実質的に単一であるものを指す。また加熱による分子間の新たな

10

20

30

40

50

化学結合は生じず、単分子で存在する。このような低分子材料の重量平均分子量（ M_w ）は5万以下であることが好ましい。これは分子量の大きい、例えば5万以上の材料に比べてある程度小さい分子量の材料のほうが多様な特性を有し、正孔または電子の移動度やバンドギャップあるいは溶媒への溶解度などを調整しやすいためである。また、低分子材料の添加量は、発光層14Cに用いられる高分子材料：低分子材料の混合比率が、その重量比で10：1以上1：2以下になるようにすることが好ましい。高分子材料：低分子材料の混合比率が10：1未満では、低分子材料の添加による効果が低くなるためである。また、この混合比率が1：2を超える場合には、発光材料としての高分子材料が有する特性が得られにくくなるためである。このような低分子材料としては、例えば、ベンジン、スチリルアミン、トリフェニルアミン、ポルフィリン、トリフェニレン、アザトリフェニレン、テトラシアノキノジメタン、トリアゾール、イミダゾール、オキサジアゾール、ポリアリーラルカン、フェニレンジアミン、アリーラルアミン、オキサゾール、アントラセン、フルオレノン、ヒドラゾン、スチルベンあるいはこれらの誘導体、または、ポリシラン系化合物、ビニルカルバゾール系化合物、チオフェン系化合物あるいはアニリン系化合物等の複素環式共役系のモノマーあるいはオリゴマーを用いることができる。さらに具体的な材料としては、
 - ナフチルフェニルフェニレンジアミン、ポルフィリン、金属テトラフェニルポルフィリン、金属ナフトロシアニン、ヘキサシアノアザトリフェニレン、7,7,8,8-テトラシアノキノジメタン（TCNQ）、7,7,8,8-テトラシアノ-2,3,5,6-テトラフルオロキノジメタン（F4-TCNQ）、テトラシアノ4,4,4'-トリス（3-メチルフェニルフェニルアミノ）トリフェニルアミン、N,N,N',N'-テトラキス（p-トリル）p-フェニレンジアミン、N,N,N',N'-テトラフェニル-4,4'-ジアミノビフェニル、N-フェニルカルバゾール、4-ジ-p-トリルアミノスチルベン、ポリ（パラフェニレンビニレン）、ポリ（チオフェンビニレン）、ポリ（2,2'-チエニルピロール）などが挙げられるが、これらに限定されるものではない。なお、発光層14Cに添加する低分子材料は1種類だけでなく、複数種類を混合して用いてもよい。

【0035】

発光層14Cを構成する発光性ゲスト材料としては、発光効率が高い材料、例えば、低分子蛍光材料、りん光色素あるいは金属錯体等の有機発光材料が用いられる。ここで青色の発光性ゲスト材料とは、発光の波長範囲が約400nm～490nmの範囲にピークを有する化合物を示す。このよう化合物として、ナフトレン誘導体、アントラセン誘導体、ナフトセン誘導体、スチリルアミン誘導体、ビス（アジニル）メテンホウ素錯体などの有機物質が用いられる。なかでも、アミノナフトレン誘導体、アミノアントラセン誘導体、アミノクリセン誘導体、アミノピレン誘導体、スチリルアミン誘導体、ビス（アジニル）メテンホウ素錯体から選択されることが好ましい。

【0036】

電子輸送層14Dは、発光層14Cへの電子輸送効率を高めるためのものである。電子輸送層14Dの材料としては、例えば、キノリン、ペリレン、フェナントロリン、ビススチリル、ピラジン、トリアゾール、オキサゾール、フラレーン、オキサジアゾール、フルオレノン、またはこれらの誘導体や金属錯体が挙げられる。具体的には、トリス（8-ヒドロキシキノリン）アルミニウム（略称Alq3）、アントラセン、ナフトレン、フェナントレン、ピレン、アントラセン、ペリレン、プタジエン、クマリン、C60、アクリジン、スチルベン、1,10-フェナントロリンまたはそれらの誘導体や金属錯体が挙げられる。

【0037】

電子輸送層14Dと第2電極層16との間には、LiF、Li₂Oなどよりなる電子注入層（図示せず）を設けてもよい。この電子注入層は、電子注入効率を高めるためのものであり、電子輸送層14Dの全面に設けられている。このような電子注入層の材料としては、例えばリチウム（Li）の酸化物である酸化リチウム（Li₂O）や、セシウム（Cs）の複合酸化物である炭酸セシウム（Cs₂CO₃）、さらにはこれらの酸化物及び複

10

20

30

40

50

合酸化物の混合物を用いることができる。また、電子注入層は、このような材料に限定されることはなく、例えば、カルシウム (Ca)、バリウム (Ba) 等のアルカリ土類金属、リチウム、セシウム等のアルカリ金属、さらにはインジウム (In)、マグネシウム (Mg) 等の仕事関数の小さい金属、さらにはこれらの金属の酸化物及び複合酸化物、フッ化物等を、単体でまたはこれらの金属および酸化物及び複合酸化物、フッ化の混合物や合金として安定性を高めて使用してもよい。

【0038】

なお、有機層 14 は、発光層 14C と接するように、他の正孔輸送層をさらに有していてもよい。この他の正孔輸送層は蒸着法を用いて形成するため、低分子材料、特にモノマーを用いることが好ましい。オリゴマーまたは高分子材料のような重合された分子は蒸着中分解が起こるおそれがあるためである。なお、他の正孔輸送層に用いる低分子材料は分子量の異なる 2 種以上の材料を混合して用いてもよい。他の正孔輸送層に用いられる低分子材料としては、発光層 14C において説明した低分子材料と同様に、例えば、ベンジン、スチリルアミン、トリフェニルアミン、ポルフィリン、トリフェニレン、アザトリフェニレン、テトラシアノキノジメタン、トリアゾール、イミダゾール、オキサジアゾール、ポリアリーラルカン、フェニレンジアミン、アリーラルアミン、オキサゾール、アントラセン、フルオレノン、ヒドラゾン、スチルベンあるいはこれらの誘導体、または、ポリシラン系化合物、ビニルカルバゾール系化合物、チオフェン系化合物あるいはアニリン系化合物等の複素環式共役系のモノマー、オリゴマーまたはポリマーを用いることができる。さらに具体的な材料としては、ナフチルフェニルフェニレンジアミン、ポルフィリン、金属テトラフェニルポルフィリン、金属ナフトロシアニン、ヘキサシアノアザトリフェニレン、7,7,8,8-テトラシアノキノジメタン (TCNQ)、7,7,8,8-テトラシアノ-2,3,5,6-テトラフルオロキノジメタン (F4-TCNQ)、テトラシアノ-4,4,4-トリス(3-メチルフェニルフェニルアミノ)トリフェニルアミン、N,N,N',N'-テトラキス(p-トリル)p-フェニレンジアミン、N,N,N',N'-テトラフェニル-4,4'-ジアミノビフェニル、N-フェニルカルバゾール、4-ジ-p-トリルアミノスチルベン、ポリ(パラフェニレンビニレン)、ポリ(チオフェンビニレン)、ポリ(2,2'-チエニルピロール)などが挙げられるが、これらに限定されるものではない。

【0039】

第 2 電極層 16 は、2 以上もしくは全ての EL 素子 10W に共通に設けられた共通電極であり、各 EL 素子 10W における第 1 電極層 13 と対向配置されている。第 2 電極層 16 は、有機層 14 のみならず、開口規定絶縁膜 24 をも覆うように形成されており、例えば、2 nm 以上 15 nm 以下の厚さを有する。第 2 電極層 16 は、発光層で発生した光に対して透光性を有する導電性材料により構成された透明電極である。したがって、その構成材料としては、例えば、ITO、インジウムと亜鉛 (Zn) と酸素とを含む化合物 (例えば IZO)、ZnO (酸化亜鉛) などが好ましい。また、第 2 電極層 16 は、例えば、アルミニウム (Al)、マグネシウム (Mg)、カルシウム (Ca)、ナトリウム (Na) などの金属元素の単体または合金により構成された半透過性反射膜であってもよい。例えばマグネシウムと銀との合金 (MgAg 合金)、またはアルミニウム (Al) とリチウム (Li) との合金 (AlLi 合金) が好適である。中でも、Mg-Ag 合金の場合、膜厚比で Mg:Ag = 20:1 ~ 1:1 の範囲であることが望ましい。また、第 2 電極層 16 は、アルミキノリン錯体、スチリルアミン誘導体、フタロシアニン誘導体等の有機発光材料を含有した混合層でもよい。この場合には、さらに第 3 層として MgAg のような光透過性を有する層を別途有していてもよい。

【0040】

EL 素子 10W を覆う防湿膜 17 は、例えば酸化シリコン (SiO_x)、窒化シリコン (SiN_x)、酸化窒化シリコン (SiN_xO_y)、酸化チタン (TiO_x) または酸化アルミニウム (Al_xO_y) などの、吸湿性が低い無機材料からなる。あるいはアルミニウムなどの金属材料を用いてもよい。防湿膜 17 を設けることにより、EL 素子 10W が外気と

10

20

30

40

50

遮断され、外部環境からE L素子10W内部への水分浸入が防止される。防湿膜17は、第2電極層16だけでなく、開口規定絶縁膜24および平坦化膜218（後出）をも覆うようにほぼ一様に形成されている。すなわち、防湿膜17は、表示領域110Aから周辺領域110Bに至るまで連続的にE L素子10W、開口規定絶縁膜24および平坦化膜218を覆っている。但し、防湿膜17は、周辺領域110Bにおいて少なくとも開口規定絶縁膜24および平坦化膜218を覆っていればよい。上述したように、開口規定絶縁膜24および平坦化膜218は、いずれも吸湿性の高い有機材料により構成されているので、これらを通じてE L素子10Wの内部へ水分が浸入するのを防ぐ必要があるからである。なお、開口規定絶縁膜24が周辺領域110Bに存在しない場合、防湿膜17は平坦化膜218を覆っていればよい。また、防湿膜17は、単層構造であってもよいが、厚さを大きくする場合には多層構造としてもよい。防湿膜17における内部応力を緩和するためである。

10

【0041】

充填層18は、防湿膜17の上にほぼ一様に形成された透明な樹脂層であり、接着層としても機能するものである。この充填層18は、例えばエポキシ樹脂またはアクリル樹脂などからなり、好ましくは、充填層18は熱硬化型樹脂または紫外線硬化型樹脂などからなる。充填層18は、基体11と封止基板19との間に封止されている。

【0042】

シール部23は、封止基板19端縁部に設けられ、表示領域110Aを取り囲むように環状をなしている。シール部23は、基板111と封止基板19との間の各層を外部から封止するための部材である。このようなシール部23もまた、例えばエポキシ樹脂またはアクリル樹脂などの非導電性材料からなる。但し、導電性の接着材料により形成してもよい。その場合、シール部23は、充填層18の流出を防ぐと共に第2電極層16の電圧降下を低減する補助配線としての機能を果たすことができる。

20

【0043】

封止基板19は、充填層18およびシール部23とともに、E L素子10Wを封止するものである。封止基板19は、赤色画素10R、緑色画素10G、青色画素10Bから出射される各色光に対して高い透過性を有する透明ガラスなどの材料により構成されている。この封止基板19における基板111側の面上には、例えば、赤色フィルタ、緑色フィルタおよび青色フィルタからなるカラーフィルタ（図示せず）と、BM層（遮光膜）とが設けられている。これにより、赤色画素10R、緑色画素10G、青色画素10B内の各E L素子10Wから発せられた白色光が、上記した各色のカラーフィルタを透過することによって、赤色光、緑色光、青色光がそれぞれ出射されるようになっている。また、赤色画素10R、緑色画素10G、青色画素10B内ならびにその間の配線において反射された外光を吸収し、コントラストを改善するようになっている。また、表示領域110Aと周辺領域110Bとの間の領域における対向面19Sには、バーニア32およびブラックマトリクス33が設けられていてもよい。バーニア32は封止基板19を貼り合わせる際の位置決めを使用するものである。また、ブラックマトリクス33は、不要光を遮光するものである。赤色フィルタ、緑色フィルタおよび青色フィルタは、それぞれ例えば矩形形状で隙間なく形成されている。これら赤色フィルタ、緑色フィルタおよび青色フィルタは、顔料を混入した樹脂によりそれぞれ構成されており、顔料を選択することにより、目的とする赤、緑あるいは青の波長域における光透過率が高く、他の波長域における光透過率が低くなるように調整されている。さらに、カラーフィルタにおける透過率の高い波長範囲と、共振器構造から取り出したい光のスペクトルのピーク波長とは一致している。これにより、封止基板19から入射する外光のうち、取り出したい光のスペクトルのピーク波長に等しい波長を有するもののみがカラーフィルタを透過し、その他の波長の外光がE L素子10Wに侵入することが防止される。

30

40

【0044】

遮光膜は、例えば黒色の着色剤を混入した光学濃度が1以上の黒色の樹脂膜、または薄膜の干渉を利用した薄膜フィルタにより構成されている。このうち黒色の樹脂膜により構

50

成するようにすれば、安価で容易に形成することができるので好ましい。薄膜フィルタは、例えば、金属、金属窒化物あるいは金属酸化物よりなる薄膜を1層以上積層し、薄膜の干渉を利用して光を減衰させるものである。薄膜フィルタとしては、具体的には、クロムと酸化クロム(III)(Cr_2O_3)とを交互に積層したものが挙げられる。

【0045】

この表示装置1は、例えば次のようにして製造することができる。以下、図4～図6などを参照して、本実施の形態の表示装置の製造方法について説明する。

【0046】

まず、上述した材料よりなる基板111の上に、駆動トランジスタTr1および書込トランジスタTr2を含む画素駆動回路140を形成する。具体的には、まず、基板111上に例えばスパッタリングにより金属膜を形成する。そののち、例えばフォトリソグラフィ法やドライエッチング、あるいはウェットエッチングによりその金属膜をパターニングすることで、基板111上に金属層211G、221Gと、信号線120Aの一部とを形成する。次いで、全面をゲート絶縁膜212によって覆う。さらに、ゲート絶縁膜212の上に、チャンネル層、チャンネル保護膜、ドレイン電極およびソース電極、ならびに、金属層216D、226Dおよび金属層216S、226Sを順に、所定形状に形成する。ここで、金属層216D、226Dおよび金属層216S、226Sの形成と併せて、信号線120Aの一部、走査線130Aを第2の金属層として各々形成する。その際、金属層221Gと走査線130Aとを接続する接続部、金属層226Dと信号線120Aとを接続する接続部、金属層226Sと金属層211Gとを接続する接続部を予め形成しておく。そののち、全体を保護膜217で覆うことにより、画素駆動回路140を完成させる。その際、保護膜217における金属層216S上の所定位置に、ドライエッチングなどにより開口を形成しておく。

【0047】

画素駆動回路140を形成したのち、スピンコート法などにより、例えばポリイミドを主成分とする感光性樹脂を全面に亘って塗布する。次に、その感光性樹脂に対しフォトリソグラフィ処理を施すことにより、コンタクト部124を有する平坦化膜218を形成する。具体的には、例えば所定位置に開口を有するマスクを用いた選択的な露光および現象により、保護膜217に設けられた開口と連通するコンタクト部124を形成する。そののち、平坦化膜218を必要に応じて焼成してもよい。これにより画素駆動回路形成層112を得る。

【0048】

さらに、上述した所定の材料よりなる第1電極層13を形成する。具体的には、例えばスパッタリングによって上述の材料からなる金属膜を全面成膜したのち、その積層膜上に所定のマスクを用いて所定形状のレジストパターン(図示せず)を形成する。さらにそのレジストパターンをマスクとして用い、金属膜の選択的なエッチングを行う。その際、第1電極層13については、平坦化膜218の表面を覆うと共にコンタクト部124を充填するように形成する。

【0049】

こののち、隣り合う第1電極層13同士の隙間を充填するように開口規定絶縁膜24を形成する。具体的には、例えば第1電極層13上および平坦化膜218上に、例えばCVD(Chemical Vapor Deposition; 化学気相成長)法により、 SiO_2 等の無機絶縁材料を成膜し、フォトリソグラフィ技術およびエッチング技術を用いてパターニングすることにより、下部開口規定絶縁膜を形成する。下部開口規定絶縁膜の所定位置、詳しくは画素の発光領域を囲む位置に、上述した感光性樹脂よりなる上部開口規定絶縁膜を形成する。これにより、上部開口規定絶縁膜および下部開口規定絶縁膜よりなる開口規定絶縁膜24が形成される。

【0050】

開口規定絶縁膜24を形成したのち、基体11における第1電極層13および開口規定絶縁膜24を形成した側の表面を酸素プラズマ処理し、その表面に付着した有機物等の汚

10

20

30

40

50

染物を除去して濡れ性を向上させる。具体的には、基体 1 1 を所定温度、例えば 70 ~ 80 程度に加熱し、続いて大気圧下で酸素を反応ガスとするプラズマ処理 (O₂ プラズマ処理) を行う。

【0051】

プラズマ処理を行ったのち、撥水化処理 (撥液化処理) を行うことにより、特に上部開口規定絶縁膜の上面及び側面の濡れ性を低下させる。具体的には、大気圧下で 4 フッ化メタンを反応ガスとするプラズマ処理 (CF₄ プラズマ処理) を行い、その後、プラズマ処理のために加熱された基体 1 1 を室温まで冷却することで、上部開口規定絶縁膜の上面及び側面を撥液化し、その濡れ性を低下させる。なお、この CF₄ プラズマ処理においては、第 1 電極層 1 3 の露出面および下部開口規定絶縁膜についても多少の影響を受けるが、第 1 電極層 1 3 の材料である ITO および下部開口規定絶縁膜の構成材料である SiO₂ などはフッ素に対する親和性に乏しいため、酸素プラズマ処理で濡れ性が向上した面は濡れ性がそのままに保持される。

10

【0052】

次いで、第 1 電極層 1 3 のうち、上部開口規定絶縁膜に囲まれた領域内の露出している部分を完全に覆うように上述した所定の材料および厚みの正孔注入層 1 4 A、正孔輸送層 1 4 B、発光層 1 4 C、電子輸送層 1 4 D を、例えば蒸着法によって順に積層することで有機層 1 4 を形成する。さらに、有機層 1 4 を挟んで第 1 電極層 1 3 と対向するように全面に亘って第 2 電極層 1 6 を形成する。そののち、第 2 電極層 1 6 を所定形状にパターンニングすることで EL 素子 1 0 W を得る。

20

【0053】

正孔注入層 1 4 A は、蒸着により形成するのみならず、スピンコート法や液滴吐出法などの塗布法により形成してもよい。その場合、特に、上部開口規定絶縁膜に囲まれた領域に正孔注入層 1 4 A の形成材料を選択的に配する必要上、液滴吐出法であるインクジェット方式や、ノズルコート方式を用いることが好ましい。

【0054】

こののち、全体を覆うように、下地に対して影響を及ぼすことのない程度に、成膜粒子のエネルギーが小さい成膜方法、例えば蒸着法や CVD 法により、上述した材料よりなる防湿膜 1 7 を形成する。例えば、アモルファス窒化シリコンからなる防湿膜 1 7 を形成する場合には、CVD 法によって 2 ~ 3 μm の膜厚に形成する。この際、有機層 1 4 の劣化による輝度の低下を防止するため、成膜温度を常温に設定すると共に、防湿膜 1 7 の剥がれを防止するために膜のストレスが最小になる条件で成膜することが望ましい。また、電子輸送層 1 4 D、電子注入層 1 4 E、第 2 電極層 1 6 および防湿膜 1 7 の形成は、望ましくは、大気に暴露されることなく同一の成膜装置内において連続して行われる。これにより大気中の水分による有機層 1 4 の劣化が防止される。

30

【0055】

最後に、防湿膜 1 7 の上に充填層 1 8 を設け、シール部 2 3 を介して封止基板 1 9 を貼り合わせる。以上により、表示装置 1 が完成する。

【0056】

[表示装置 1 の作用・効果]

この表示装置 1 では、各画素に対して走査線駆動回路 1 3 0 から書込トランジスタ Tr 2 のゲート電極を介して走査信号が供給されると共に、信号線駆動回路 1 2 0 から画像信号が書込トランジスタ Tr 2 を介して保持容量 Cs に保持される。すなわち、この保持容量 Cs に保持された信号に応じて駆動トランジスタ Tr 1 がオンオフ制御され、これにより、EL 素子 1 0 W に駆動電流 Id が注入され、正孔と電子とが再結合して発光が起こる。この光は、表示装置 1 が上面発光型 (トップエミッション型) であることから、第 2 電極層 1 6、防湿膜 1 7、充填層 1 8、各色のカラーフィルタ (図示せず) および封止基板 1 9 を透過して取り出される。このようにして、表示装置 1 において映像表示 (カラー映像表示) がなされる。

40

【0057】

50

ところで、従来の有機EL表示装置では、吸湿によって有機層の劣化が生じ、EL素子における発光輝度が低下し、あるいは発光が不安定になるなど、経時的な安定性を欠き、寿命が短いといった問題が指摘されていた。

【0058】

これに対し、本実施の形態では、防湿膜17によって周辺領域110Bにおける平坦化膜218を覆うようにした。このため、EL素子10Wの下地となる平坦化膜218が、水分を含む外気から十分に遮蔽される。その結果、簡素な構造でありながら周辺領域110Bから表示領域110Aへの水分浸入を効果的に防止することができる。よって、水による発光素子の劣化を抑え、高い動作信頼性を実現できる。さらに、例えば特許文献2, 3に提案されている構造のように、表示領域と周辺領域との間の距離を広くする必要もないことから、狭額縁化をも図ることができる。

10

【0059】

<変形例>

続いて、上記実施の形態の変形例(変形例1~6)について説明する。なお、上記実施の形態における構成要素と同一のものには同一の符号を付し、適宜説明を省略する。

【0060】

[変形例1]

図7は、変形例1としての表示装置1Aの断面構成を表す。本変形例は、保護膜217と平坦化膜218との間に防湿膜25を、平坦化膜218と開口規定絶縁膜24との間に防湿膜26をそれぞれ設けるようにしたものであり、他は上記実施の形態と同様の構成を有する。防湿膜25, 26は、いずれも防湿膜17と同様に吸湿性が低い無機材料からなり、平坦化膜218の端縁もしくは開口規定絶縁膜24の端縁から表示領域110Aへ向かうように延在している。防湿膜17に加え、防湿膜25, 26を設けることにより、外部環境からEL素子10W内部への水分浸入が確実に防止される。保護膜217と平坦化膜218との境界部分、もしくは平坦化膜218と開口規定絶縁膜24との境界部分を伝播してEL素子10Wへ至る水分を確実に遮断できるからである。

20

【0061】

[変形例2~5]

図8, 図9A, 図9Bは、それぞれ、変形例2~4としての有機EL表示装置(以下、単に表示装置)1B, 1C1, 1C2の断面構成を表す。また、図9Cは、変形例5としての表示装置1C3の要部を拡大した断面構成を表す。本変形例2~5は、いずれもシール部23と対応する領域に分離溝27を設けるようにしたものであり、他は上記実施の形態と同様の構成を有する。分離溝27は、シール部23と同様に、XY平面において環状をなすように表示領域110Aを取り囲むように延在している。分離溝27は、表示領域110Aに設けられた開口規定絶縁膜24および平坦化膜218と、周辺領域110Bに設けられた開口規定絶縁膜24および平坦化膜218とを分離するものであり、その底部は保護膜217に到達している。分離溝27においては、防湿膜17(表示装置1C3では防湿膜29)が充填されている。特に表示装置1B(変形例2)では、分離溝27の内壁面を防湿膜17が直接覆っている。また、表示装置1C1, 1C2, 1C3(変形例3~5)では、分離溝27における内壁面および底面を覆うように金属膜28がさらに設けられている。なお、この金属膜28は、図9Bに示した表示装置1C2のように、例えば第2電極層16と同種の材料からなり、第2電極層16と一体化されたものであってもよい。あるいは、図9A, 9Cにそれぞれ示した表示装置1C1, 1C3のように、金属膜28を第2電極層16と別体として形成する場合、第2電極層16と異なる材料を選択してもよい。また、表示装置1C3のように、表示領域110Aにおける開口規定絶縁膜24および第2電極層16を覆う防湿膜17とは別体として、分離溝27の内部を充填し、かつ周辺領域110Bにおける保護膜217および平坦化膜218を覆う3層構造の防湿膜29を設けるようにしてもよい。防湿膜29は、保護膜217および平坦化膜218の上に、第1~第3の層291~293が順に積層されたものである。第1および第3の層291, 293は、例えば窒化シリコン(SiN_x)などからなる窒化膜であり、第2の

30

40

50

層 2 9 2 は、例えば酸化シリコン (SiO_x) などの酸化物膜である。また、表示装置 1 B , 1 C 1 , 1 C 2 , 1 C 3 では、分離溝 2 7 を複数設けるようにしてもよい。

【 0 0 6 2 】

表示装置 1 B , 1 C 1 , 1 C 2 では、防湿膜 1 7 に加え、分離溝 2 7 を設けるようにしたので、外部環境から E L 素子 1 0 W 内部への水分浸入がより確実に防止される。水分の伝播経路となる保護膜 2 1 7 および平坦化膜 2 1 8 が、表示領域 1 1 0 A と周辺領域 1 1 0 B とで分断されているためである。

【 0 0 6 3 】

[変形例 6]

図 1 0 は、変形例 6 としての表示装置 1 D の断面構成を表す。本変形例の表示装置 1 D は、防湿膜 1 7 の代わりに防湿膜 3 4 を有する点を除き、他は上記実施の形態と同様の構成である。防湿膜 3 4 は、基板 1 1 1 の端面から封止基板 1 9 の端面に亘って連続して設けられ、それら基板 1 1 1 と封止基板 1 9 とによって挟まれた E L 素子 1 0 W を含む領域を封止するものである。防湿膜 3 4 は、例えば防湿膜 1 7 と同様の無機材料からなる。

【 0 0 6 4 】

表示装置 1 D では、防湿膜 3 4 を設けるようにしたので、外部環境から E L 素子 1 0 W 内部への水分浸入が確実に防止される。周辺領域 1 1 0 B における平坦化膜 2 1 8 および開口規定絶縁膜 2 4 が防湿膜 3 4 によって覆われ、水分を含む外気から十分に遮蔽されるからである。さらに、防湿膜 3 4 を導電性の無機材料によって形成した場合、それを信号線として利用することもできる。このような導電性材料としては、例えば白金 (Pt) , 金 (Au) , 銀 (Ag) , クロム (Cr) , タングステン (W) , ニッケル (Ni) , 銅 (Cu) , 鉄 (Fe) , コバルト (Co) , タantal (Ta) , アルミニウム (Al) , ネオジム (Nd) あるいはモリブデン (Mo) などの金属元素の単体または合金から構成されている。例えば、このような合金として、銀を主成分とし、0 . 3 重量% ~ 1 重量% のパラジウム (Pd) および 0 . 3 重量% ~ 1 重量% の銅を含有する Ag - Pd - Cu 合金や、Al - Nd 合金を用いることができる。その際、外部との接続を行う F P C などの接続配線 3 1 の一端を防湿膜 3 4 に埋め込むようにしてもよい。なお、防湿膜 3 4 を、シール部 2 3 と共通化してもよい。

【 0 0 6 5 】

< 適用例 >

以下、上記実施の形態および変形例で説明した表示装置 (表示装置 1 , 1 A ~ 1 D) の適用例について説明する。上記実施の形態等の表示装置は、テレビジョン装置、デジタルカメラ、ノート型パーソナルコンピュータ、携帯電話等の携帯端末装置あるいはビデオカメラなどのあらゆる分野の電子機器に適用することが可能である。すなわち、上記実施の形態等の表示装置は、外部から入力された映像信号あるいは内部で生成した映像信号を、画像あるいは映像として表示するあらゆる分野の電子機器に適用することが可能である。

【 0 0 6 6 】

(モジュール)

上記実施の形態等の表示装置は、例えば、図 1 1 に示したようなモジュールとして、後述する第 1 ~ 第 6 の適用例 1 ~ 6 などの種々の電子機器に組み込まれる。このモジュールは、例えば、基板 1 1 1 の一辺に、封止基板 1 9 等から露出した領域 2 1 0 を設け、この露出した領域 2 1 0 に、信号線駆動回路 1 2 0 および走査線駆動回路 1 3 0 の配線を延長して外部接続端子 (図示せず) を形成したものである。外部接続端子には、信号の入出力のためのフレキシブルプリント配線基板 (F P C ; Flexible Printed Circuit) 2 2 0 が設けられていてもよい。

【 0 0 6 7 】

(適用例 1)

図 1 2 は、上記実施の形態等の表示装置が適用されるテレビジョン装置の外観を表したものである。このテレビジョン装置は、例えば、フロントパネル 3 1 0 およびフィルターガラス 3 2 0 を含む映像表示画面部 3 0 0 を有しており、この映像表示画面部 3 0 0 は、

上記実施の形態等に係る表示装置により構成されている。

【0068】

(適用例2)

図13A, 13Bは、上記実施の形態等の表示装置が適用されるデジタルカメラの外観を表したものである。このデジタルカメラは、例えば、フラッシュ用の発光部410、表示部420、メニュースイッチ430およびシャッターボタン440を有しており、その表示部420は、上記実施の形態等に係る表示装置により構成されている。

【0069】

(適用例3)

図14は、上記実施の形態等の表示装置が適用されるノート型パーソナルコンピュータの外観を表したものである。このノート型パーソナルコンピュータは、例えば、本体510、文字等の入力操作のためのキーボード520および画像を表示する表示部530を有しており、その表示部530は、上記実施の形態等に係る表示装置により構成されている。

10

【0070】

(適用例4)

図15は、上記実施の形態等の表示装置が適用されるビデオカメラの外観を表したものである。このビデオカメラは、例えば、本体部610、この本体部610の前方側面に設けられた被写体撮影用のレンズ620、撮影時のスタート/ストップスイッチ630および表示部640を有しており、その表示部640は、上記実施の形態等に係る表示装置により構成されている。

20

【0071】

(適用例5)

図16A, 16Bは、上記実施の形態等の表示装置が適用される携帯電話機の外観を表したものである。この携帯電話機は、例えば、上側筐体710と下側筐体720とを連結部(ヒンジ部)730で連結したものであり、ディスプレイ740、サブディスプレイ750、ピクチャーライト760およびカメラ770を有している。そのディスプレイ740またはサブディスプレイ750は、上記実施の形態等に係る表示装置により構成されている。

30

【0072】

(適用例6)

図17A, 17Bは、いわゆるタブレット型パーソナルコンピュータ(PC)の外観構成を表している。このタブレット型PCは、例えば、表示部810と、それを保持する筐体などの非表示部820と、電源スイッチなどの操作部830とを備えている。なお、操作部830は、図17Aに示したように非表示部820の前面に設けられていてもよいし、図17Bに示したように上面に設けられていてもよい。表示部810は、映像表示機能のほか、位置入力機能(ポインティング機能)を備えたタッチスクリーン(タッチパネル)である。

【0073】

<その他の変形例>

40

以上、実施の形態およびいくつかの変形例を挙げて本技術を説明したが、本技術は上記実施の形態等に限定されるものではなく、種々変形が可能である。例えば、上記実施の形態等では、周辺領域110Bにおける平坦化膜218などを防湿膜17, 29によって覆うことで、EL素子10W内部への水分浸入を防止するようにした本開示はこれに限定されるものではない。例えば図18に示した表示装置1Eのように、防湿膜17の替わりにシール部23と対応する領域に分離溝27を設けると共に、シール部23を金属材料によって形成し、シール部23の一部が分離溝27を充填するようにしてもよい(第7の変形例)。シール部23に適用される金属材料としては、例えば白金(Pt)、金(Au)、銀(Ag)、クロム(Cr)、タングステン(W)、ニッケル(Ni)、銅(Cu)、鉄(Fe)、コバルト(Co)、タンタル(Ta)、アルミニウム(Al)、ネオジム(N

50

d)あるいはモリブデン(Mo)などの金属元素の単体または合金が挙げられる。より具体的には、銀を主成分とし、0.3重量%~1重量%のパラジウム(Pd)および0.3重量%~1重量%の銅を含有するAg-Pd-Cu合金や、Al-Nd合金を用いることができる。または、ジュメット線(鉄ニッケル合金線を心材とした銅線(銅被覆鉄ニッケル合金線))をシール部23に適用してもよい。

【0074】

表示装置1Eでは、金属材料からなるシール部23の一部によって充填された分離溝27を設けるようにしたので、外部環境からEL素子10W内部への水分浸入がより確実に防止される。さらに、シール部23を配線として利用することもできる。シール部23は、例えば、マスクを用い、真空蒸着法、スパッタリング法、イオンプレーティング法あるいはメッキ法等を用いて形成することができる。また、ジュメット線を用いる場合には、ジュメット線をバーナーなどにより加熱して所定位置に溶着することでシール部23を形成すればよい。なお、シール部23を形成する際、外部との接続を行うFPCなどの引出線(図示せず)の一端をシール部23に埋め込むようにしてもよい。

10

【0075】

また、本技術では、例えば図19Aに示した表示装置1F1のように、シール部23と対応する領域に分離溝27を設けると共に、その分離溝27の内面を金属層28によって覆い、さらに分離溝27の内部を防湿膜17で充填するようにしてもよい(第8の変形例)。あるいは図19Bに示した表示装置1F2のように、防湿膜17とは別体として、分離溝27の内部を充填する3層構造の防湿膜29を設けるようにしてもよい。防湿膜29は、第1~第3の層291~293が順に積層されたものである。第1および第3の層291, 293は、例えば窒化シリコン(SiN_x)などからなる窒化膜であり、第2の層292は、例えば酸化シリコン(SiO_x)などの酸化物膜である(第9の変形例)。あるいは、図20に示した表示装置1Gのように、2つの分離溝27A, 27Bを設け、内部を金属層28で充填してもよい(第10の変形例)。

20

【0076】

本技術では、例えば図21Aに示した表示装置1H1のように、表示領域110Aにおける開口規定絶縁膜24と有機層14との間に、防湿膜17を設けるようにしてもよい。これにより、表示領域110Aにおける開口規定絶縁膜24に含まれる水分によってEL素子10Wが劣化するのを防ぐことができる(第11の変形例)。さらに、図21Bに示した表示装置1H2のように平坦化膜218と開口規定絶縁膜24との間にも防湿膜26を設けるとよい(第12の変形例)。なお、表示装置1H1, 1H2を形成するには、開口規定絶縁膜24を形成したのち、その開口規定絶縁膜24を覆うように防湿性かつ絶縁性を有する所定の材料(例えばSiN)を、CVD法、リソグラフィ法、エッチングで形成する。そののち、有機層14を例えば蒸着法で形成したのち、第2電極層16を形成することで表示装置1H1, 1H2を得る。

30

【0077】

また、本技術では、例えば図22A, 22Bに示した表示装置1J(第13の変形例)のように、防湿膜17の代わりに、高い防湿性を有する絶縁性樹脂からなる防湿膜35を設けるようにしてもよい。表示装置1Jでは、防湿膜35が、基板111の端面から封止基板19の端面に亘って連続して設けられ、それら基板111と封止基板19とによって挟まれたEL素子10Wを含む領域を封止する。表示装置1Jは、例えば図23に示したように封止基板19の外縁に沿って所定の樹脂を塗布したのち、それを硬化させて防湿膜35を形成することで得られる。また、例えば図24A, 24Bに示した表示装置1K(第14の変形例)のように、樹脂層351を形成したのち、さらにスパッタリング等により無機材料を樹脂層351の上に堆積させ、無機層352を形成することで2層構造の防湿膜35としてもよい。なお、樹脂層を形成することなく、直接、無機材料や金属材料を堆積させることで防湿膜35を形成してもよい。そのような無機材料としては、酸化シリコン(SiO_x)、窒化シリコン(SiN_x)、酸窒化シリコン(SiN_xO_y)、炭化シリコン(SiC_x)、酸化チタン(TiO_x)または酸化アルミニウム(Al_xO_y)などの、

40

50

吸湿性が低い無機材料が好適である。また、金属材料としては、白金 (Pt)、金 (Au)、銀 (Ag)、クロム (Cr)、タングステン (W)、ニッケル (Ni)、銅 (Cu)、鉄 (Fe)、コバルト (Co)、タンタル (Ta)、チタン (Ti)、アルミニウム (Al)、ネオジム (Nd) あるいはモリブデン (Mo) などの金属元素の単体または合金、例えば、銀を主成分とし、0.3重量%~1重量%のパラジウム (Pd) および0.3重量%~1重量%の銅を含有する Ag-Pd-Cu 合金や、Al-Nd 合金、ジュメット線 (鉄ニッケル合金線を心材とした銅線 (銅被覆鉄ニッケル合金線)) などが好適である。また、例えば図 25 に示した表示装置 1L (第 15 の変形例) のように、ガラス層 37 によって基板 111 と封止基板 19 との間の EL 素子 10W を含む領域を封止してもよい。表示装置 1L は、基板 111 の外縁に沿ってフリットガラスを塗布したのち、例えば図 26 に示したようにそのフリットガラスに対しレーザを照射するなどしてガラス層からなる防湿膜 37 を形成し基板 111 と封止基板 19 とを溶接することで得られる。また、例えば図 27 に示した表示装置 1M (第 16 の変形例) のように基板 111 および封止基板 19 の端面を凹部形状に加工したのち、防湿膜 35, 37 を形成してもよい。

10

【0078】

また、本技術では、防湿膜 17 の代わりにシール部 23 と対応する領域に分離溝 27 を設けると共に、その分離溝 27 の内面を金属層 28 と 3 層構造の防湿膜によって覆うようにしてもよい。そのような 3 層構造の防湿膜は、例えば窒化シリコン (SiN_x) などからなる一対の窒化物膜、もしくは炭化シリコン (SiC_x) などからなる一対の炭化物膜によって酸化シリコン (SiO_x) などの酸化物膜を挟んだものである。または、酸化シリコン (SiO_x) などからなる一対の酸化物膜により、窒化シリコン (SiN_x) などからなる窒化物膜もしくは炭化シリコン (SiC_x) などからなる炭化物膜を挟んだものである。そのような 3 層構造の防湿膜は、例えば窒化シリコン (SiN_x) などからなる一対の窒化物膜によって酸化シリコン (SiO_x) などの酸化物膜を挟んだものである。なお、その 3 層構造の防湿膜を周辺領域 110B にまで延在し、平坦化膜 218 などを防湿膜 34 によって覆うようにすると、より防湿性能が向上するので好ましい。

20

【0079】

また、上記実施の形態では、全ての有機発光素子を、白色光を発するものとし、別途設けたカラーフィルタにより各色光を取り出す場合について例示したが、本技術はこれに限定されない。例えば有機層 14 を所定の材料を用いて塗り分けることで赤色光、緑色光および青色光をそれぞれ発する有機発光素子を設けるようにしてもよい。

30

【0080】

さらには、黄色光および青色光をそれぞれ発する有機発光素子 10Y, 10B と赤色、緑色、青色および黄色のカラーフィルタとを併用することで、赤色光、緑色光、青色光および黄色光を取り出すようにした表示装置であってもよい。あるいは、黄色光および青色光をそれぞれ発する有機発光素子 10Y, 10B と赤色、緑色および青色のカラーフィルタとを併用することで、赤色光、緑色光および青色光を取り出すようにした表示装置であってもよい。

【0081】

また、本技術は、上記実施の形態において説明した各層の材料や積層順序、あるいは成膜方法などに限定されるものではない。例えば、上記実施の形態においては、第 1 電極層 13 をアノード、第 2 電極層 16 をカソードとする場合について説明したが、第 1 電極層 13 をカソード、第 2 電極層 16 をアノードとしてもよい。なお、第 1 電極層 13 がカソードとして使われる場合には、第 1 電極層 13 は正孔注入性の高い材料により構成されていることが望ましい。但し、アルミニウム合金のように、表面の酸化皮膜の存在や、仕事関数が大きくないことによる正孔注入障壁が問題となる材料においても、適切な正孔注入層を設けることによって第 1 電極層 13 として使用することが可能である。さらに、上記実施の形態では、発光部 20 の構成を具体的に挙げて説明したが、他の層をさらに備えていてもよい。例えば、第 1 電極層 13 と有機層 14 との間に、酸化クロム (III) (Cr_2O_3)、ITO (Indium-Tin Oxide: インジウム (In) およびスズ (Sn) の酸化

40

50

物混合膜)などからなる正孔注入用薄膜層を備えていてもよい。

【0082】

また、本技術は以下のような構成を取り得るものである。

(1)

対向配置された第1および第2の基板と、
前記第1の基板上に設けられた第1の有機絶縁層と、
前記第1の有機絶縁層上における前記第2の基板と対向する表示領域に配列された複数の発光素子と、
前記第1の基板上における前記表示領域を取り囲む周辺領域において前記第1の有機絶縁層を覆う第1の防湿膜と
を有する表示装置。

10

(2)

前記第1の有機絶縁層の上に、前記複数の発光素子を相互に分離すると共に前記複数の発光素子における発光領域を各々画定する第2の有機絶縁層を有し、
前記第1の防湿膜は、前記周辺領域において前記第2の有機絶縁層をも覆っている
上記(1)記載の表示装置。

(3)

前記第1の防湿膜は、前記表示領域においても前記第2の有機絶縁層を覆っている
上記(2)記載の表示装置。

(4)

前記第1の防湿膜は、前記表示領域から前記周辺領域に至るまで連続的に前記第1の有機絶縁層を覆っている
上記(1)~(3)のいずれか1つに記載の表示装置。

20

(5)

前記第1の有機絶縁層と前記第2の有機絶縁層との間に、第2の防湿膜を有する
上記(1)~(4)のいずれか1つに記載の表示装置。

(6)

前記第1の基板と前記第1の有機絶縁層との間に無機絶縁層を有し、
前記無機絶縁層と前記第1の有機絶縁層との間に第3の防湿膜を有する
上記(1)~(5)のいずれか1つに記載の表示装置。

30

(7)

前記第1の防湿膜は、窒化シリコン(SiNx)または金属材料からなる
上記(1)~(6)のいずれか1つに記載の表示装置。

(8)

前記表示領域に設けられた前記第1の有機絶縁層と、前記周辺領域に設けられた前記第1の有機絶縁層とを分離する分離溝を有する
上記(1)~(7)のいずれか1つに記載の表示装置。

(9)

前記分離溝の内面は、前記第1の防湿膜によって覆われている
上記(8)記載の表示装置。

40

(10)

前記分離溝の内面は、金属材料層によって覆われている
上記(8)記載の表示装置。

(11)

前記表示領域と前記周辺領域とは、前記第2の基板の、前記第1の基板と対向する対向面における周縁部に沿って設けられたシール部によって仕切られている
上記(1)~(10)のいずれか1つに記載の表示装置。

(12)

前記シール部は、導電性材料からなる
上記(11)記載の表示装置。

50

(1 3)

前記第 1 の防湿膜は、

前記第 1 の基板の端面から前記第 2 の基板の端面に亘って設けられ、前記第 1 の基板と前記第 2 の基板とによって挟まれた領域を封止する

上記 (1) ~ (1 2) のいずれか 1 つに記載の表示装置。

(1 4)

前記第 1 の防湿膜は、金属材料または無機絶縁材料からなる

上記 (1 3) 記載の表示装置。

(1 5)

表示装置を備えた電子機器であって、

前記表示装置は、

対向配置された第 1 および第 2 の基板と、

前記第 1 の基板上に設けられた第 1 の有機絶縁層と、

前記第 1 の有機絶縁層上における前記第 2 の基板と対向する表示領域に配列された複数の発光素子と、

前記第 1 の基板上における前記表示領域を取り囲む周辺領域において前記第 1 の有機絶縁層を覆う防湿膜と

を有する

電子機器。

10

【符号の説明】

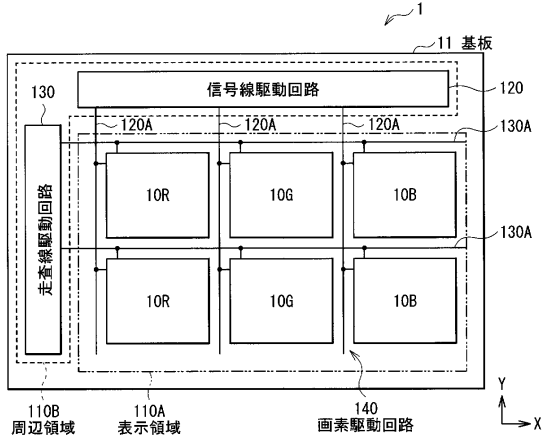
20

【 0 0 8 3 】

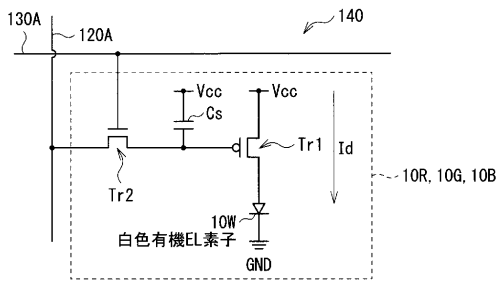
1 0 W ... 白色有機 E L 素子、1 1 ... 基体、1 1 1 ... 基板、1 1 2 ... 画素駆動回路形成層、1 2 ... 発光素子形成層、1 3 ... 第 1 電極層、1 4 ... 有機層、1 4 A ... 正孔注入層、1 4 B ... 正孔輸送層、1 4 C ... 発光層、1 4 D ... 電子輸送層、1 6 ... 第 2 電極層、1 7 , 2 5 , 2 6 , 2 9 , 3 4 , 3 5 ... 防湿膜、1 8 ... 充填層、1 9 ... 封止基板、2 0 ... 発光部、2 1 ... 間隙部、2 2 ... 導電膜パターン、2 3 ... シール部、2 4 ... 開口規定絶縁膜、1 2 4 ... コンタクト部、2 7 ... 分離溝、2 8 ... 金属膜、1 1 0 A ... 表示領域、1 1 0 B ... 周辺領域、1 2 0 ... 信号線駆動回路、1 2 0 A ... 信号線、1 3 0 ... 走査線駆動回路、1 3 0 A ... 走査線、1 4 0 ... 画素駆動回路、2 1 7 ... 保護膜 (パッシベーション膜)、2 1 8 ... 平坦化膜、C s ... キャパシタ (保持容量)、T r 1 ... 駆動トランジスタ、T r 2 ... 書込トランジスタ。

30

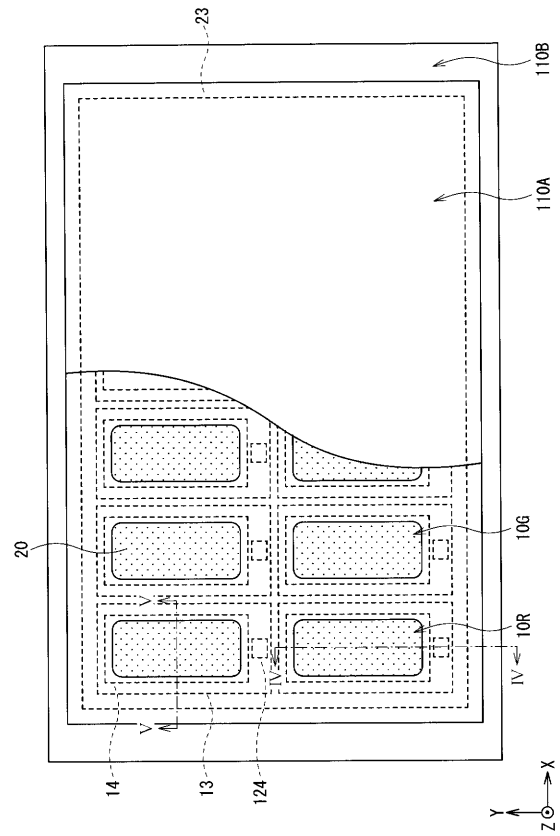
【 図 1 】



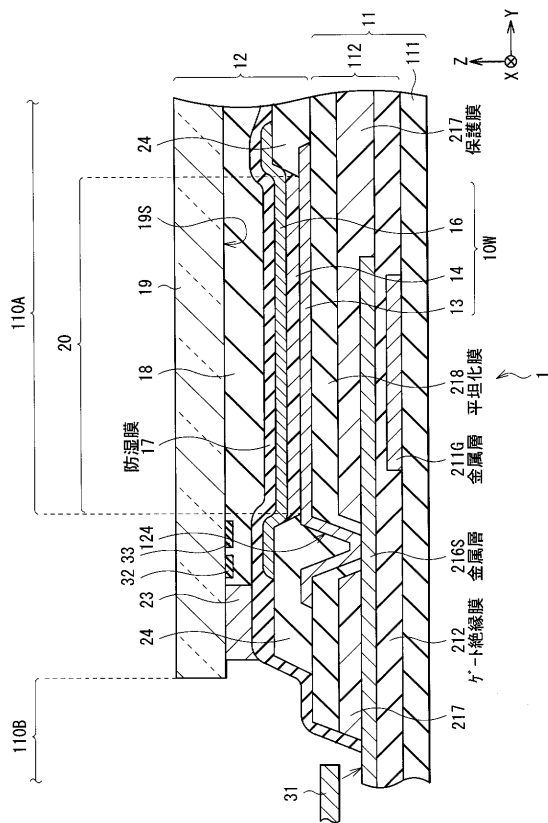
【 図 2 】



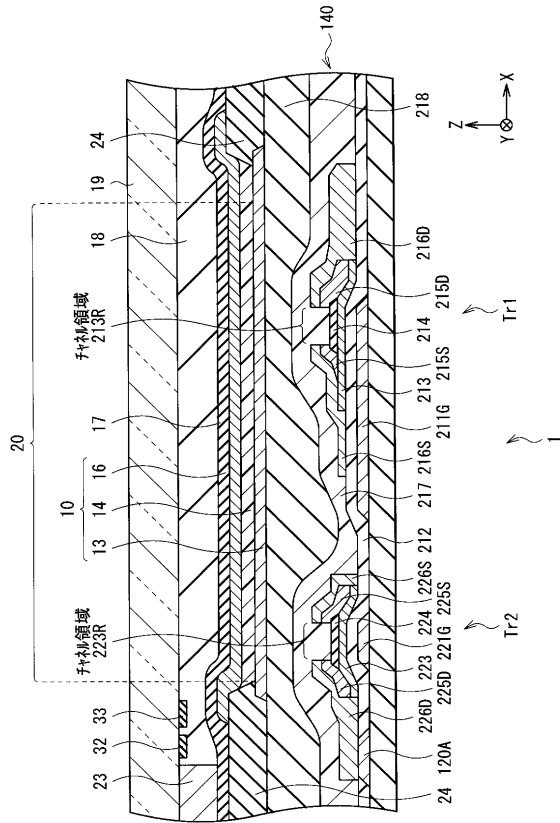
【 図 3 】



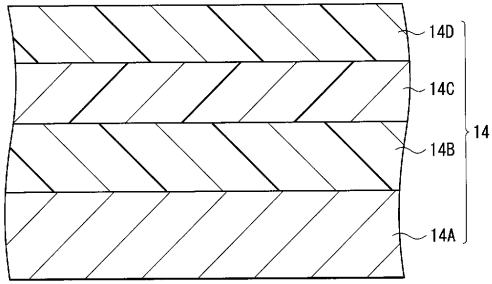
【 図 4 】



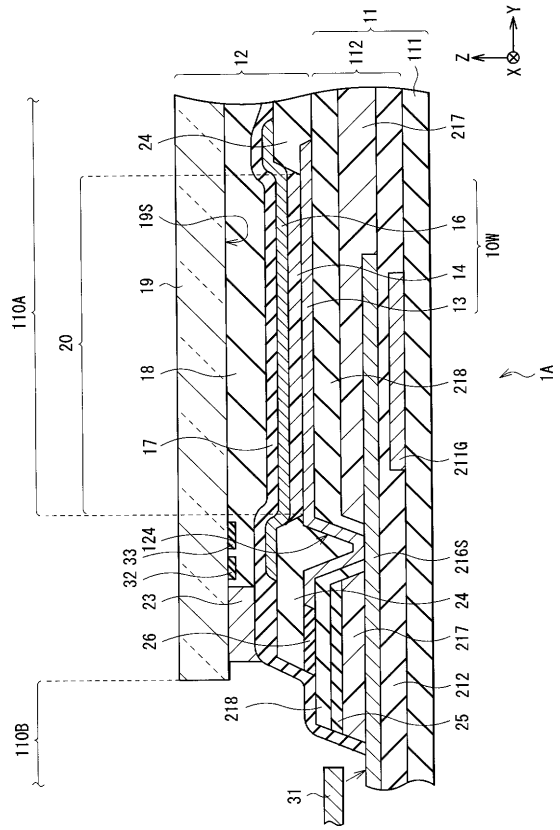
【 図 5 】



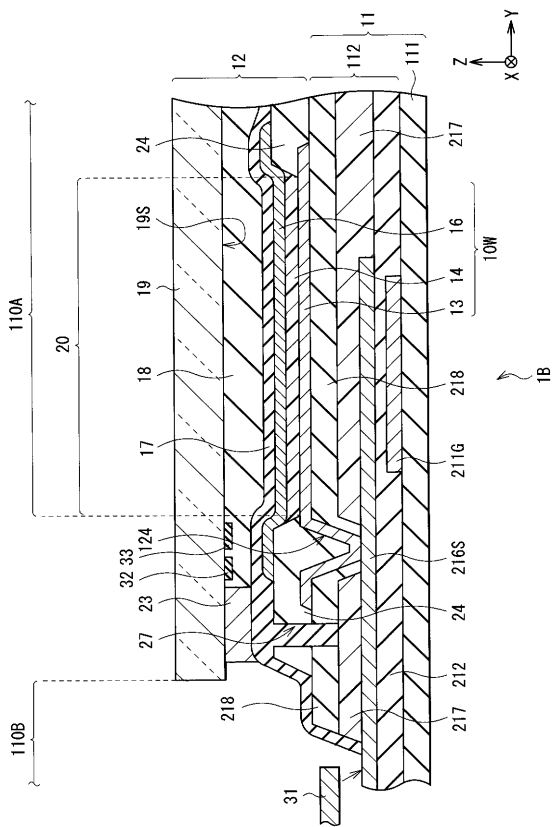
【図 6】



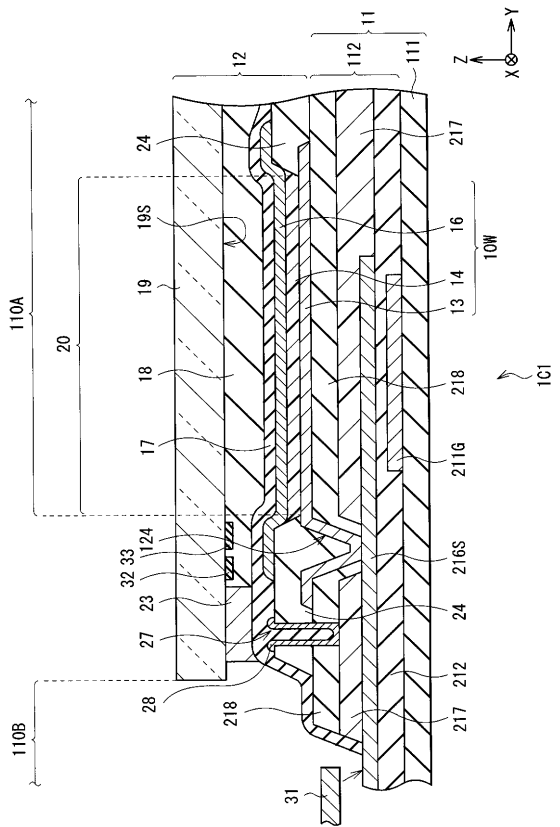
【図 7】



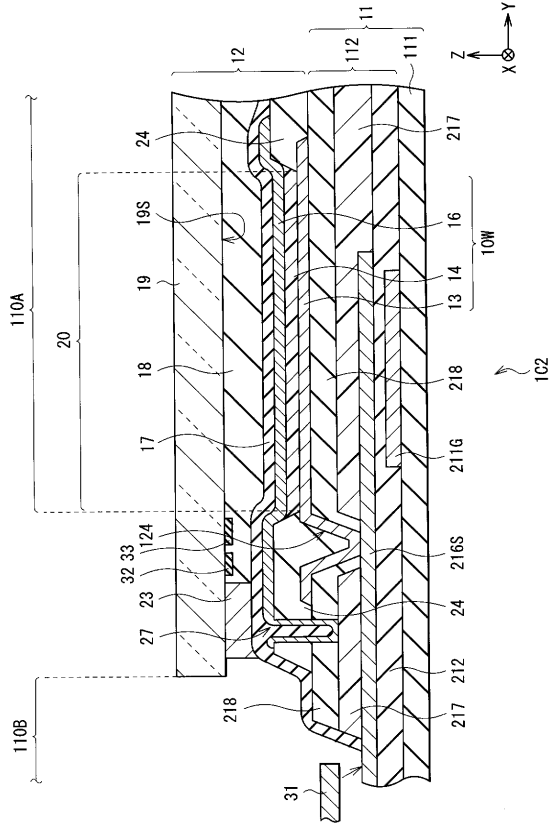
【図 8】



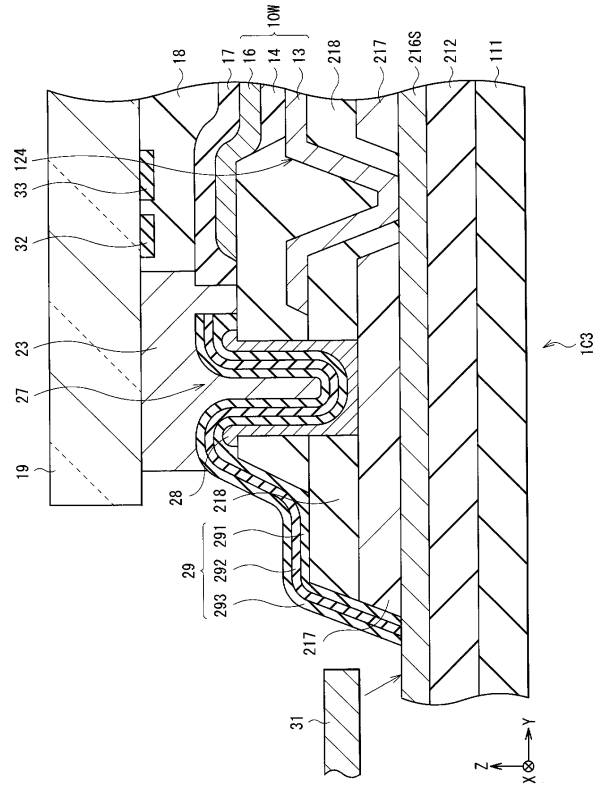
【図 9 A】



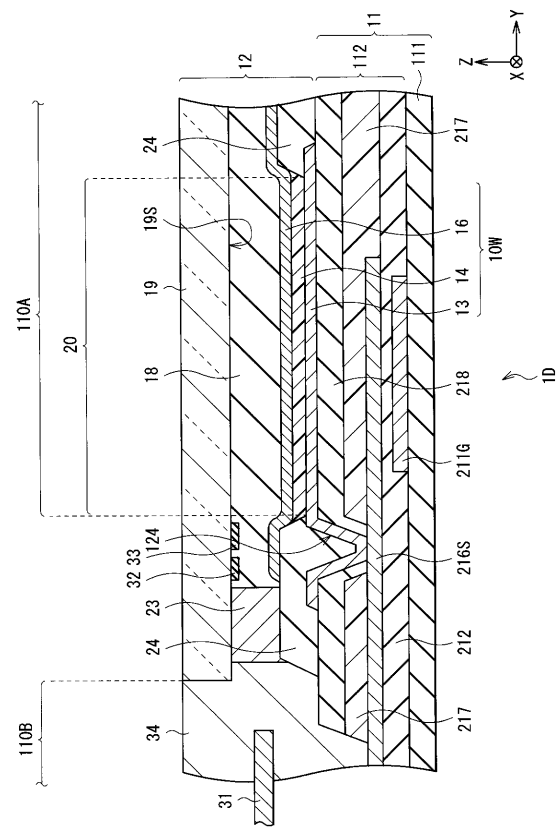
【図9B】



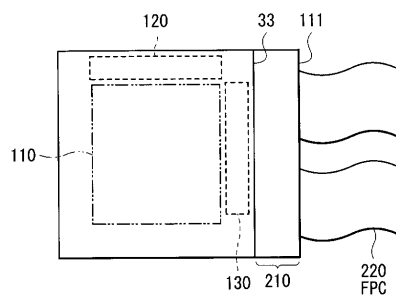
【図9C】



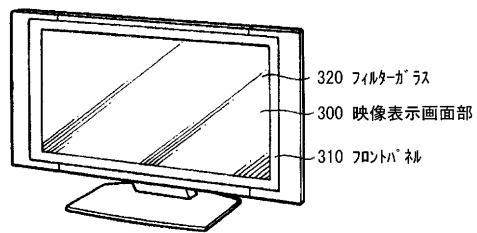
【図10】



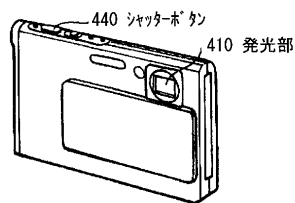
【図11】



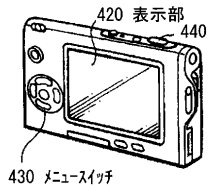
【図12】



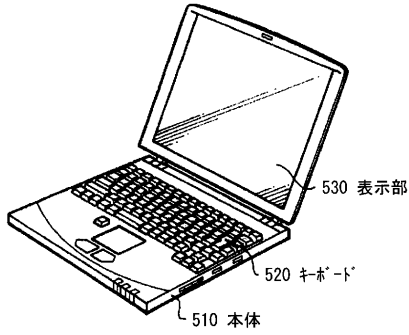
【図13A】



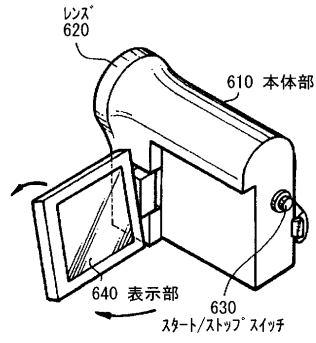
【図13B】



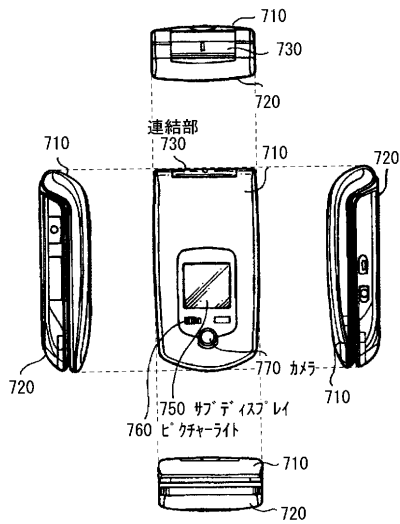
【図14】



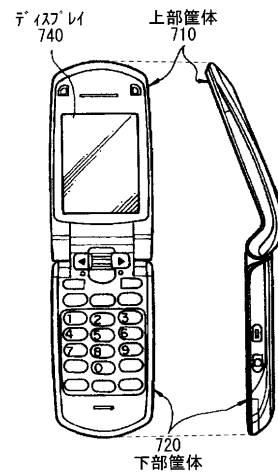
【図15】



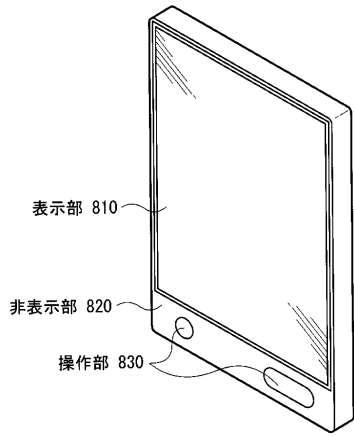
【図16A】



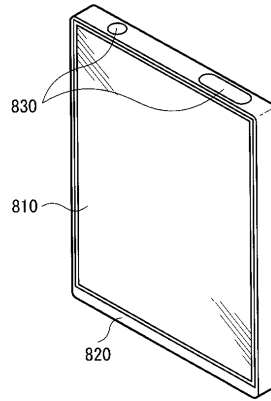
【図16B】



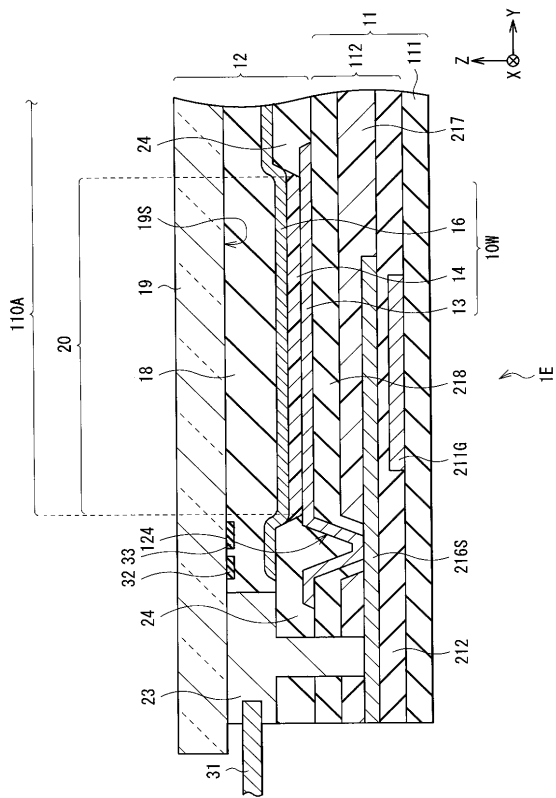
【図17A】



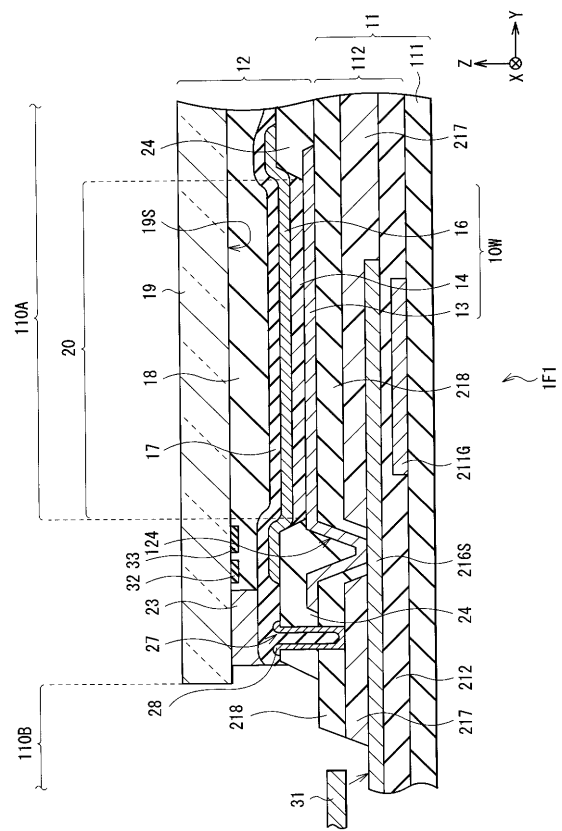
【図17B】



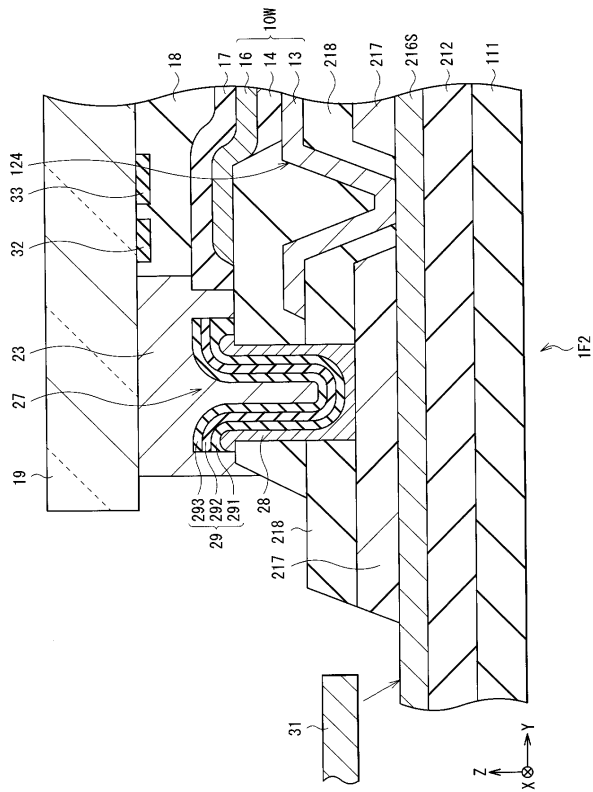
【図18】



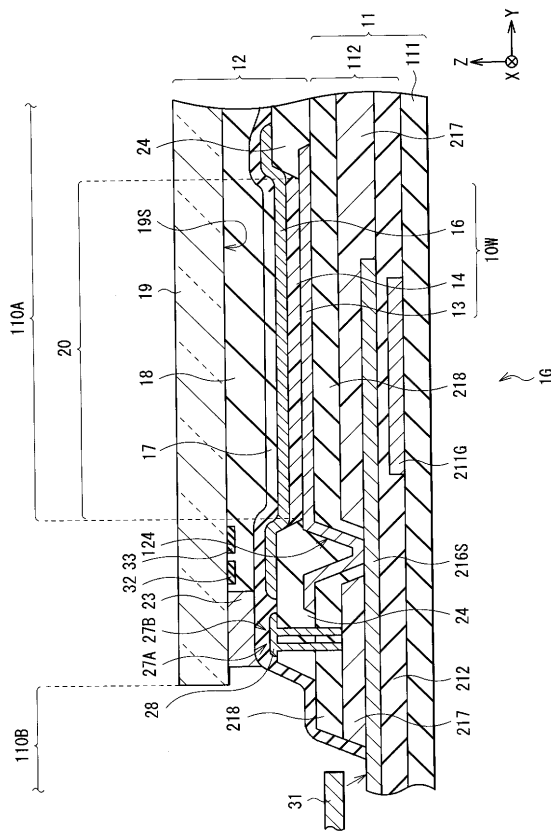
【図19A】



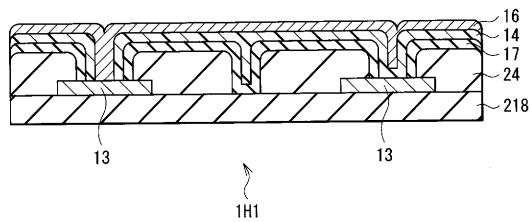
【 図 19 B 】



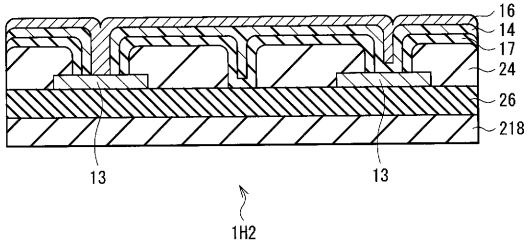
【 図 20 】



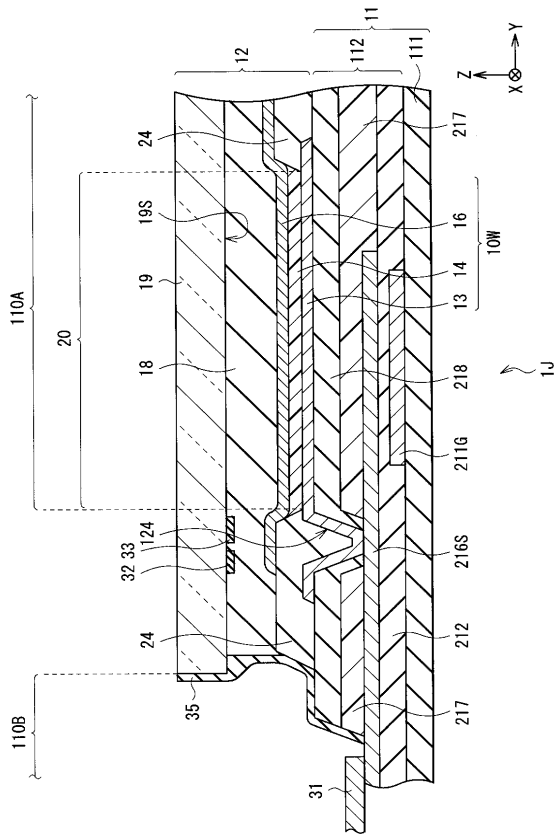
【 図 21 A 】



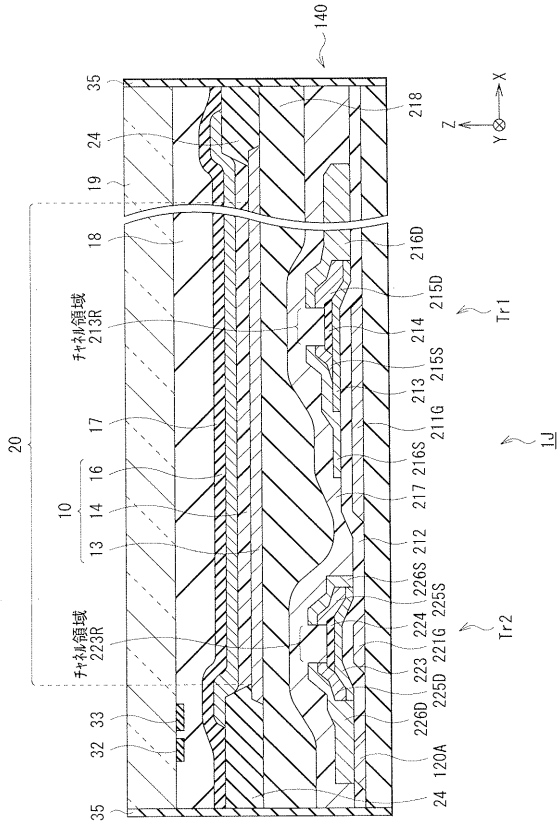
【 図 21 B 】



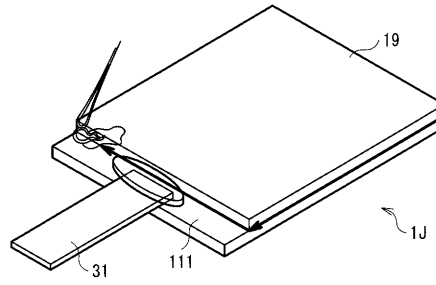
【 図 22 A 】



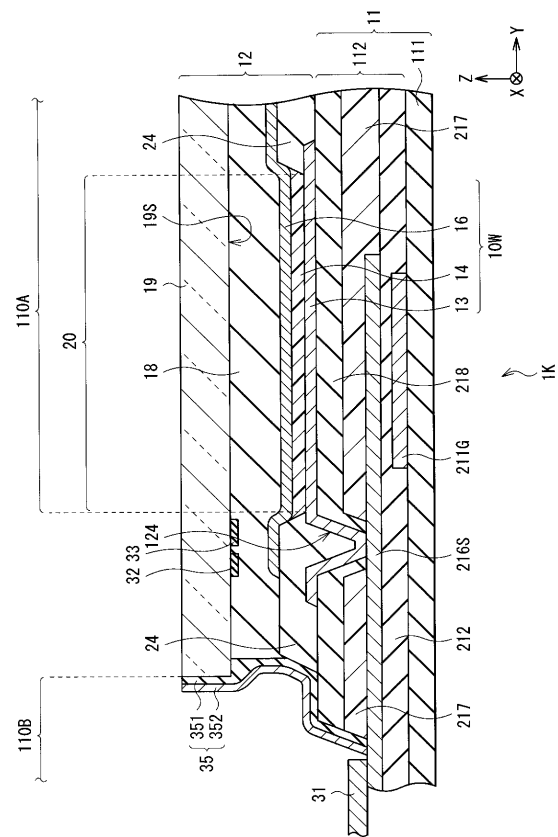
【図22B】



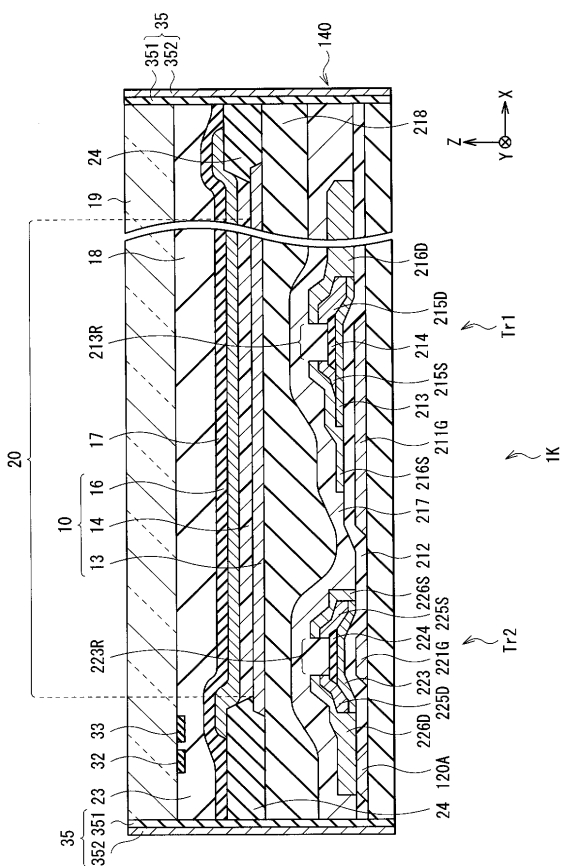
【図23】



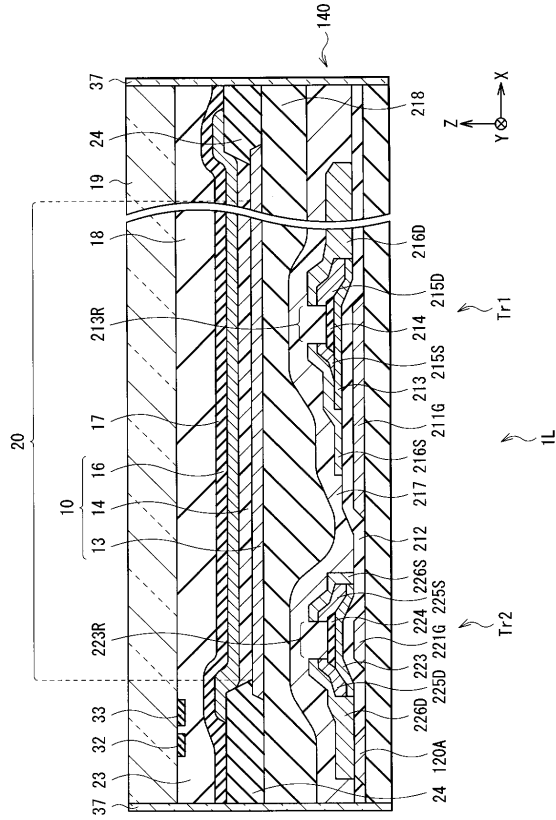
【図24A】



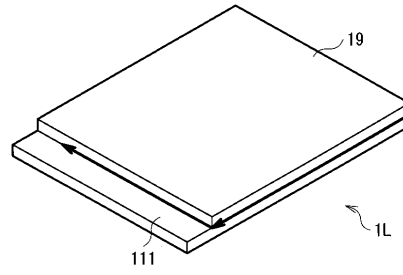
【図24B】



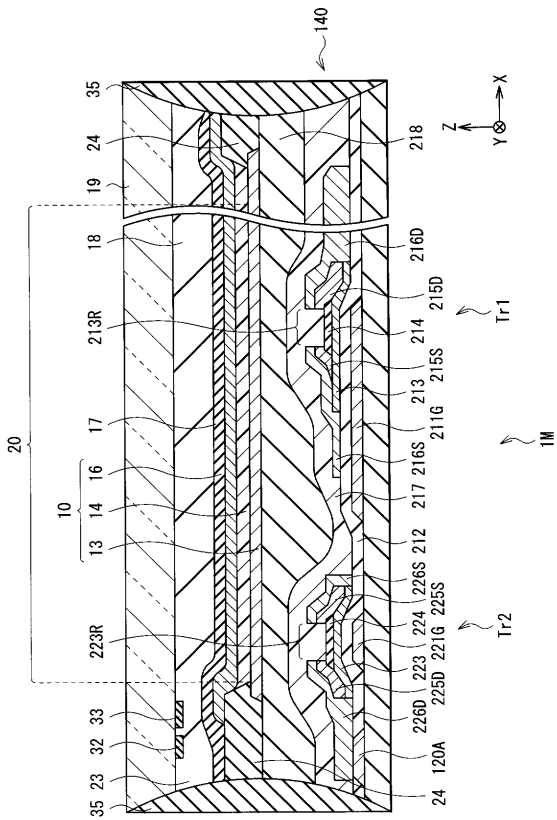
【図 25】



【図 26】



【図 27】



フロントページの続き

- (72)発明者 中平 忠克
東京都港区港南1丁目7番1号 ソニー株式会社内
- (72)発明者 横関 弥樹博
東京都港区港南1丁目7番1号 ソニー株式会社内
- (72)発明者 西 正太
東京都港区港南1丁目7番1号 ソニー株式会社内
- (72)発明者 古立 学
東京都港区港南1丁目7番1号 ソニー株式会社内

審査官 辻本 寛司

- (56)参考文献 特開2002-324666(JP,A)
特開2003-347044(JP,A)
特開2011-138635(JP,A)
特開2003-323125(JP,A)
特開2002-151253(JP,A)
国際公開第2011/108020(WO,A1)
国際公開第2004/057920(WO,A1)
特開2005-108678(JP,A)
特開2005-129415(JP,A)
特開2005-038842(JP,A)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

H05B 33/04
G09F 9/30
H01L 27/32
H01L 51/50
H05B 33/12
H05B 33/22